

## ИМЕННОЙ УКАЗАТЕЛЬ К ЖУРНАЛУ «ФИЗИКА И ТЕХНИКА ПОЛУПРОВОДНИКОВ»

Том 27, 1993 год

- Абайдулина Т. Г., см. Житинская М. К. 10, 1724
- Абашкина С. А., Корольков В. И., Римшанс Я. С., Скрыль Ю. И., Табаров Т. С. Численный расчет нестационарных характеристик в вертикальных полевых фототранзисторах на основе GaAs. 6, 966
- Аббасов Г. З., см. Трофимов В. Т. 7, 1158
- Абдураимов А., Зайнабидинов С. З., Маматкаримов О. О., Турсунов И. Г., Химматкулов О. Динамическая проводимость компенсированного кремния при всестороннем гидростатическом сжатии. 3, 516
- Абдураимов А., Зайнабидинов С. З., Маматкаримов О. О., Химматкулов О. Тензосвойства диодов с барьером Шоттки при всестороннем гидростатическом сжатии. 7, 1216
- Абдурахманов К. П., Далиев Х. С., Куликов Г. С., Лебедев А. А., Утамуррадова Ш. Б., Юсупова Ш. А. Локальное геттерирование железа слоем металла, напыленного на поверхность кремния. 7, 1222
- Абдурахманов К. П., см. Куликов Г. С. 8, 1389
- Абрамов А. П., Абрамова И. Н., Вербин С. Ю., Герлович И. Я., Григорьев С. Р., Игнатьев И. В., Каримов О. З., Новиков А. Б., Новиков Б. В. Фотолюминесценция вырожденного электронного газа в слоях GaAs : Si, выращенных методом молекулярно-пучковой эпитаксии. 7, 1175
- Абрамова И. Н., см. Абрамов А. П. 7, 1175
- Аверин С. В., Новиков С. В., Мескида-Кюстес А., Потапов В. Т., Хейме К., Царев А. Н., Шмарцев Ю. В. Фотодиодные МПМ структуры с низкой величиной плотности темнового тока. 11/12, 1811
- Аверкиев Н. С., Монахов А. М. Размерное квантование дырок в сложной валентной зоне во внешнем магнитном поле, параллельном поверхности. 4, 600
- Аветисян Г. Х., см. Горбылев В. А. 9, 1453
- Авров Д. Д., см. Сафаралиев Г. К. 3, 402
- Адамашвили Г. Т., Пейкришвили М. Д., Бицадзе Д. Д. Нелинейные поверхностные акустические волны в сверхрешетках GaAs—AlAs. 5, 832
- Азимов С. А., Юнусов М. С., Нуркузиев Г. Исследование кинетики спада фотопроводимости в кремнии, легированном осмием. 7, 1073
- Айвазов А. А., см. Будагян Б. Г. 8, 1365
- Айвазов А. А., см. Будагян Б. Г. 9, 1489
- Айдаралиев М., Зотова Н. В., Карандашев С. А., Матвеев Б. А., Стусь Н. М., Талалакин Г. Н. Длинноволновые низкочастотные лазеры на основе соединений A<sup>III</sup>B<sup>V</sup>. 1, 21
- Акимов А. В., Криволапчук В. В., Полетаев Н. К., Шофман В. Г. Люминесцентное исследование долговременной кинетики носителей в эпитаксиальном арсениде галлия. 2, 310
- Акимов Б. А., Албул А. В., Иванчик И. И., Рябова Л. И., Слынько Е. И., Хохлов Д. Р. Влияние легирования галлием на свойства твердых растворов Pb<sub>1-x</sub>Ge<sub>x</sub>Te. 2, 351
- Албул А. В., см. Акимов Б. А. 2, 351
- Алейнер И. Л., Ивченко Е. Л. Электронные минизоны в сверхрешетках (GaAs)<sub>N</sub>(AlAs)<sub>M</sub> при четном и нечетном M. 4, 594
- Алекперов О. Э., Гамзаев Д. О., Кулибеков А. М., Сулейманов Р. А. Анизотропия фотопроводимости в монокристаллах GeS. 7, 1180
- Алексеев М. В., см. Забродский А. Г. 11/12, 2033
- Алешкин Б. Я., Аншон А. В., Карпович И. А. Поляризационная зависимость межзонного оптического поглощения квантовой ямы InGaAs в GaAs. 8, 1344
- Алешкин В. Я., Звонков Б. Н., Линькова Е. Р., Мурел А. В., Романов Ю. А. Вольт-фарадные характеристики сверхрешеток. 6, 931
- Алешкин В. Я., Красильник З. Ф., Ревин Д. Г. Фотолуминесценция из квантовой ямы с высокой концентрацией фотоносителей. 7, 1190
- Алешкин В. Я., Романов Ю. А. Поглощение инфракрасного излучения дырками в структурах с квантовыми ямами. 2, 329

- Аллавердиев К., см. Кулибеков А. 7, 1229
- Аль-Бакурр Ф., Дидык А. Ю., Козлов И. П., Оджаев В. Б., Петров В. В., Просолович В. С., Сохацкий А. С., Янковский О. Н. Процессы отжига и перестройки радиационных дефектов в кремнии, имплантированном высокоэнергетическими ионами бора. 5, 829
- Амиров Р. Х., Гавриленко В. И. Междоузельное излучение горячих дырок в Ge и неравновесные фононы. 8, 1297
- Андреев Б. А., Голубев В. Г., Емцев В. В., Кропотов Г. И., Оганесян Г. А., Шмальц К. Процессы формирования «новых доноров» при термообработке кремния с различной концентрацией кислорода. 4, 567
- Андреев В. М., Антипов В. Г., Калиновский В. С., Каллион Р. В., Никишин С. А., Рувимов С. С., Степанов М. В., Танклевская Е. М., Хвостиков В. П. (AlGaAs/GaAs)-фотоприемники на подложках Si, полужонные комбинированным методом пучковой и молекулярно-пучковой эпитаксии. 1, 141
- Андреев В. М., Калиновский В. С., Миланова М. М., Минтаиров А. М., Румянцев В. Д., Смекалин К. Е., Стругова Е. О. Спектральные и электрические характеристики гетероструктур  $n\text{-GaAs}-(n-p)\text{-Al}_x\text{Ga}_{1-x}\text{As}-p\text{-Al}_y(\text{Ga}_{1-x})\text{As}-p^+\text{-GaAs}$  ультратонкими поверхностными слоями. 1, 156
- Андреева Е. В., Зильберман А. Б., Ильин Ю. Л., Махин А. В., Мошников В. А., Яськов Д. А. Влияние этанола на электрофизические свойства диоксида олова. 7, 1095
- Андрианов А. В., Ковалев Д. И., Шуман В. Б., Ярошецкий И. Д. Время-разрешенная фотолуминесценция пористого кремния. 1, 136
- Андрухив А. М., Гадаев О. А., Иванов-Омский В. И., Цидильковский Э. И. Хвосты плотности состояний в твердых растворах  $\text{Zn}_x\text{Cd}_y\text{Hg}_{1-x-y}\text{Te}$ . 2, 348
- Андрухив М. Г., Белотелов С. В., Вирт И. С. Переходные процессы в  $n^+-p$ -структурах на основе  $\text{Cd}_x\text{Hg}_{1-x}\text{Te}$ . 11/12, 1863
- Андрюшин Е. А., Силин А. П. Кулоновское взаимодействие носителей в тонких полупроводниковых нитях. 8, 1256
- Аникин М. М., Иванов П. А., Растегаев В. П., Савкина Н. С., Сыркин А. Л., Челноков В. Е. Экспериментальный полевой транзистор на основе карбида кремния политипа 4H. 1, 102
- Антипов В. Г., см. Андреев В. М. 1, 141
- Антипов С. А., Батаронов И. А., Дрожжин А. И., Рощупкин А. М. Изменение электросопротивления тензорезисторов при изгибе. 6, 937
- Антоненко В. И., Знаменский Д. А., Калугин С. М., Леванович В. Н., Моисеев Ю. Н., Панов В. И., Тодуа П. А., Уласюк В. Н., Юсупов Р. Г. Электронные свойства границ раздела полупроводник—диэлектрик в тонкопленочном транзисторе на основе структуры  $\text{SiO}_2-\alpha\text{-Si}(\text{H})$  — пленка Ленгмюра—Блуджет. 2, 221
- Антонова И. В., Шаймеев С. С., Тыщенко И. Е. Исследование методом DLTS дефектов, образующихся в кремнии при высокотемпературном облучении ионами  $\text{N}^+$ . 2, 234
- Аншон А. В., см. Алешкин В. Я. 8, 1344
- Арапов Ю. Г., Городилов Н. А., Кузнецов О. А., Неверов В. Н., Орлов Л. К., Рубцова А. Р., Харус Г. И., Чернов А. Л., Шелушинина Н. Г., Штраппенин Г. Л. Осцилляции магнитосопротивления в напряженных сверхрешетках  $\text{Ge}/\text{Ge}_{1-x}\text{Si}_x$  в наклонном магнитном поле. 7, 1165
- Арза Рон, см. Ашкинадзе Б. М. 11/12, 1953
- Аронов Д. А., Кабулов Р. Р., Маматкулов Р., Усманов Ш., Юабов Ю. М. Последеградационные характеристики  $p-i-n$ -фотоэлементов из гидрированного аморфного кремния ( $a\text{-Si}:\text{H}$ ). 6, 1014
- Артамонов В. В., Байдуллаева А., Беляев С. В., Власенко А. И., Глазюк В. А., Мозоль П. Е. Влияние лазерного облучения на физические свойства высокоомных кристаллов  $\text{ZnSe}$ . 2, 228
- Артамонов О. М., Дмитриева О. Г., Самарин С. Н., Яковлев И. И. Исследование незаполненных электронных состояний и определение сродства к электрону  $\text{PbS}$  (100) с помощью спектроскопии обратной фотоэмиссии. 10, 1730
- Архипов В. И., Перова И. А. «Вспышечная» кинетика радиационного заряжения в неупорядоченных диэлектриках. 4, 682
- Аскаров Ш. И., см. Бахадырханов М. К. 10, 1684
- Асланов Г. А., Бурбаев Т. М., Курбатов В. А., Пенин Н. А. Нелинейность фотопроводимости германия с примесями ртути, кобальта и цинка при возбуждении излучением с  $\lambda = 10.6$  мкм. 2, 277
- Астратов В. Н., Власов Ю. А. Экситонная фотолуминесценция приповерхностных квантовых ям в системе  $\text{GaAs}/\text{AlGaAs}$ . 7, 1101
- Астров Ю. А. Токовые структуры в  $\text{Si}(\text{Zn})$ . 11/12, 1973
- Астров Ю. А., Хорев С. А. Исследование структуры токовых нитей в  $\text{Si}(\text{Zn})$ . 11/12, 2027
- Афонин В. В., Гальперин Ю. М. Акустоэлектрический эффект и термоэдз увлечения электронов фононами в режиме слабой локализации. 1, 115
- Ахиезер И. Т., Гуревич Ю. Г., Закиров Н. Геометрия образца и гальваномагнитные эффекты в полупроводниках. 4, 628
- Ашкинадзе Б. М., Коэн Е., Арза Рон, Пфайффер Л. Воздействие свободных электронов на динамику экситонов в  $QW$ -структурах. 11/12, 1953
- Ашмонтас С., Градаускас И., Ширмулис Э. Влияние смещения на фото-

- отклик кремниевых структур при освещении импульсами  $\text{CO}_2$ -лазера. 7, 1185
- Ашмонта С., Скучене А. Асимметрия перколяционной электропроводности компенсированного  $n\text{-InP}$ . 2, 307
- Аюпов Б. М., см. Бахтурова Л. Ф. 4, 588
- Бабаев Т. Р., см. Керимова Т. Г. 8, 1398
- Бабенцов В. Н., Байдуллаева А., Власенко А. И., Горбань С. И., Даулетмуратов Б. К., Мозоль П. Е. Механизмы образования нарушенного слоя в  $p\text{-CdTe}$  под действием лазерных импульсов наносекундной длительности. 10, 1618
- Бабенцов В. Н., Бекетов Г. В., Горбань С. И. Преобразование системы дефектов вблизи поверхности кристаллов  $\text{CdTe}$ ,  $\text{Zn}_x\text{Cd}_{1-x}\text{Te}$ ,  $\text{CdTe}_{1-x}\text{Se}_x$ , обработанных ионами аргона. 3, 504
- Бабенцов В. Н., Власенко А. И., Сочинский Н. В., Тарбаев Н. И. Влияние галлия на спектры низкотемпературной фотолуминесценции теллурида кадмия при диффузионном легировании. 10, 1599
- Бабий П. И., см. Гнатенко Ю. П. 10, 1639
- Байдуллаева А., см. Артамонов В. В. 2, 228
- Байдуллаева А., см. Бабенцов В. Н. 10, 1618
- Байдуллаева А., Даулетмуратов Б. К., Власенко А. И., Гнатюк В. А., Мозоль П. Е. Фотозлектрические свойства пленок теллурида кадмия, подвергнутых лазерному облучению. 1, 56
- Байдусь Н. В., см. Бедный Б. И. 7, 1125
- Байдусь Н. В., см. Карпович И. А. 10, 1736
- Баковец В. Г., см. Бахтурова Л. Ф. 4, 588
- Бакуева Л. Г., Ильин В. И., Мусихин С. Ф., Рабизо О. В., Шаронова Л. В., Гирич А. В. Сверхрешетки  $\text{PbS}-\text{CdS}$ , полученные лазерным испарением в вакууме. 11/12, 1866
- Бакуева Л. Г., Ильин В. И., Мусихин С. Ф., Шаронова Л. В. Алмазоподобные пленки, полученные лазерным напылением, и многослойные структуры на их основе. 11/12, 1868
- Балмуш Н. И., см. Клюканов А. А. 4, 655
- Банная В. Ф., Литвак-Горская Л. Б., Луговая Г. Я. Особенности низкотемпературной проводимости германия, легированного ртутью. 10, 1661
- Баранов А. Н., Воронина Т. И., Лагунова Т. С., Сиповская М. А., Шерстнев В. В., Яковлев Ю. П. Свойства эпитаксиального арсенида индия, легированного редкоземельными элементами. 3, 421
- Басс Ф. Г., Евтушенко О. М., Панчева А. П. Пространственная модуляция неквадратичного закона дисперсии носителей заряда внешним высокочастотным полем в полупроводниках. 10, 1747
- Басюк Е. В., Дмитрук Н. Л., Маева О. И. Фоточувствительность поверхности-барьерных структур на основе  $\text{InP}$  с микрорельефной границей раздела. 3, 415
- Батаронов И. А., см. Антипов С. А. 6, 937
- Батукова Л. М., см. Карпович И. А. 10, 1736
- Бауэр Г., см. Трофимов В. Т. 7, 1158
- Бахадырханов М. К., Аскарлов Ш. И., Курбанова У. Х. Исследование влияния магнитного поля на условия возбуждения и параметры неустойчивостей тока инфракрасных частот в  $\text{Si(S)}$ . 10, 1684
- Бахтурова Л. Ф., Баковец В. В., Долгосерова И. П., Аюпов Б. М. Послойное исследование ионно-имплантированного кремния методами эллипсометрии и избирательного смачивания. 4, 588
- Бедный Б. И., Байдусь Н. В. Влияние рекомбинации в области пространственного заряда на люкс-вольтовые характеристики поверхностной фотоздс в  $\text{GaAs}$  и  $\text{InP}$ . 7, 1125
- Бедный Б. И., см. Карпович И. А. 10, 1736
- Безрядин Н. Н., см. Сысоев Б. И. 1, 131
- Бекетов Г. В., см. Бабенцов В. Н. 3, 504
- Белотелов С. В., см. Андрухив М. Г. 11/12, 1863
- Беляев С. В., см. Артамонов В. В. 2, 228
- Беляев А. П., Рубец В. П., Тошходжаев Х. А., Калинин И. П. Туннельный эффект как причина тока, ограниченного контактной эмиссией в гетероструктуре  $\text{In}_2\text{O}_3\text{-ZnSe-(Zn}_{1-x}\text{Cd}_x\text{Te)}_{1-y}\text{(In}_2\text{Te}_3)_y\text{-In}$ . 3, 532
- Беляев А. П., Рубец В. П., Тошходжаев Х. А., Калинин И. П. Инверсия типа проводимости слоя селенида цинка в гетероструктуре  $\text{In}_2\text{O}_3\text{-ZnSe-(Zn}_{1-x}\text{Cd}_x\text{Te)}_{1-y}\text{(In}_2\text{Te}_3)_y\text{-In}$ . 3, 527
- Беляков Л. В., Горячев Д. Н., Сресели О. М., Ярошецкий И. Д. Светочувствительные структуры Шоттки на пористом кремнии. 8, 1371
- Беляков Л. В., Горячев Д. Н., Сресели О. М., Ярошецкий И. Д. Роль света в процессах формирования пористого кремния на подложках  $p$ -типа. 11/12, 1963
- Беляков Л. В., Горячев Д. Н., Сресели О. М., Ярошецкий И. Д. Эффективная электролюминесценция пористого кремния. 11/12, 1815
- Бер Б. Я., Быстров С. В., Зушинский Д. А., Корнякова О. В., Ле Туан, Новиков С. В., Савельев И. Г., Третьяков В. В., Чалдышев В. В., Шмарцев Ю. В. О возможности получения изопериодических с подложкой  $\text{InP}$  слоев  $\text{In}_{0.52}\text{Al}_{0.48}\text{As}$  методом жидкофазной эпитаксии при низких температурах ( $\sim 650^\circ\text{C}$ ). 9, 1480
- Березин А. В., см. Мусихин С. Ф. 3, 513
- Березин А. В., см. Немов С. А. 2, 299
- Берил С. И., Покатилов Е. П., Зотов А. С., Фарах М., Фай Л. К. Экранированное кулоновское взаимодействие и поляронный экситон в МДП структуре. 1, 12
- Беркелиев А., Жилыев Ю. В., Назаров Н., Рудь В. Ю., Рудь Ю. В., Федоров Л. М. Эффект усиления наведенного фотоплюрохризма в структурах  $p\text{-n-GaP/p-Si}$ . 10, 1624
- Берлов П. А., Буланый М. Ф., Коваленко А. В. Исследование спектров фото-

- люминесценции пластических деформированных кристаллов ZnS. 7, 1121
- Берман Л. С., Грехов И. В., Каримов И. Н., Остроумова Е. В. Поверхностные состояния на кремнии в МДП (металл—диэлектрик—полупроводник) структурах с туннельно-тонким слоем окисла. 6, 917
- Берман Л. С., Иванов А. М., Павлова М. Л., Ременюк А. Д., Строкан Н. Б. Радиационные дефекты в кремнии, облученном  $\alpha$ -частицами при низкой температуре. 11/12, 1795
- Бицадзе Д. Д., см. Адамашвили Г. Т. 5, 832
- Богобоющийся В. В., см. Гасан-заде С. Г. 9, 1508
- Богословская А. Б., Колчанова Н. М., Меняхин Ф. И., Попов А. А., Сукач Г. А. Исследование распределения примеси в области гетерограницы  $p$ -GaInAsSb/ $p$ -GaAlAsSb. 9, 1574
- Боднарь И. В., см. Киндяк В. В. 7, 1154
- Божевольнов В. Б., см. Яфясов А. М. 5, 762
- Бойко С. И., Горбань И. С., Крохмаль А. П., Осинский В. И., Рожко И. А. Люминесценция поляритонов вблизи поверхности в арсениде галлия. 5, 815
- Болгов С. С., Кислый В. П., Малютенко В. К., Савченко А. П. Барическая зависимость люминесценции гетероструктур  $Cd_xHg_{1-x}Te/CdTe$ . 1, 171
- Болотов Л. Н., Козлов В. А., Макаренко И. В., Титков А. Н. Визуализация поверхности (111) кремниевых шайб  $p$ -типа в атмосферных условиях с помощью сканирующего туннельного микроскопа. 8, 1375
- Борани И., см. Вербицкая Е. М. 11/12, 2055
- Бочкарева Л. В., см. Зимин С. П. 1, 185
- Бочкарева Л. В., см. Кузнецов В. С. 5, 785
- Бочкова Т. М., см. Коваленко А. В. 8, 1335
- Бреслер М. С., Гусев О. Б., Титков А. Н., Чебан В. Н., Яковлев Ю. П., Гулицуис Э., Освальд И., Панграц И., Шимечек Т. Излучательная рекомбинация на гетеропереходе  $P$ -типа  $n$ -GaInAsSb/ $N$ -GaSb. 4, 615
- Бреслер М. С., Яссиевич И. Н. Физические свойства и фотолюминесценция пористого кремния. 5, 871
- Бродовой А. В., см. Лашкарев Г. В. 6, 1067
- Бродовой А. В., см. Лашкарев Г. В. 8, 1381
- Брудный В. Н., Колин Н. Г., Потапов А. И. Глубокие ловушки в  $n$ -GaAs, облученном быстрыми нейтронами. 2, 260
- Будагян Б. Г., Айвазов А. А., Сазонов А. Ю. Влияние концентрации азота на микроструктуру и темновую проводимость пленок  $\alpha$ - $Si_{1-x}N_x$ : H. 8, 1365
- Будагян Б. Г., Айвазов А. А., Становов О. Н. Осцилляции фотопроводимости и особенности релаксационной кинетики в  $\alpha$ -Si: H. 9, 1489
- Буланый М. Ф., см. Берлов П. А. 7, 1121
- Бурбаев Т. М., см. Асланов Г. А. 2, 277
- Бутусов Д. М., Кудряшов Н. А., Кучеренко С. С., Рывкин Б. С. Механизм  $p$ - $n$ -структур при электропоглощении света. 2, 214
- Бушмарина Г. С., см. Житинская М. К. 10, 1724
- Быстров С. Б., см. Бер Б. Я. 9, 1480
- Быстров С. Д., Крещук А. М., Новиков С. В., Полянская Т. А., Савельев И. Г. Квантовое и классическое времена релаксации и свойства гетерограницы в селективно легированных гетероструктурах InP/In<sub>0.53</sub>Ga<sub>0.47</sub>As. 4, 645
- Ваксман Ю. Ф., см. Краснов А. Н. 3, 511
- Валь А., Кузьма М., Поцяск М., Шеррейг Е. М. Распределение концентрации ртути при импульсном лазерном отжиге  $Cd_xHg_{1-x}Te$ . 4, 622
- Васильев А. В., Зингер Г. М., Розельфельд Ю. Б., Рыскин А. И. Фотоионизация иона  $Fe^{2+}$  в ZnS: релаксация решетки. 8, 1305
- Васильев Ю. Б., см. Иванов Ю. Л. 11/12, 1997
- Васильев Ю. Б., Сучалкин С. Д. Инверсная заселенность уровней пространственно-квантования в двумерных системах InAs/AlSb/GaSb. 11/12, 1992
- Васильев Ю. Б., см. Сучалкин С. Д. 11/12, 2078
- Васько Ф. Т., Солдатенко Ю. Н. Индуцируемые током добавки к эффективной диэлектрической проницаемости неоднородных полупроводниковых сплавов. 4, 695
- Васько Ф. Т., Солдатенко Ю. Н. Нелинейная восприимчивость электронов в неоднородных полупроводниковых сплавах. 6, 1058
- Вдовин В. И., см. Кузнецов О. А. 10, 1591
- Вейс А. Н. Энергетический спектр вакансий халькогена в ионно-имплантированном сульфиде свинца. 8, 1384
- Вейс А. Н., Рыданов А. Ю., Суворова Н. А. Энергетический спектр PbTe(Zn<sup>2+</sup>) по данным оптического поглощения. 4, 701
- Векслер М. И., см. Грехов И. В. 1, 88
- Вербин С. Ю., см. Абрамов А. П. 7, 1175
- Вербицкая Е. М., Еремин В. К., Иванов А. М., Строкан Н. В. Особенности генерационного тока в облученных  $\alpha$ -частицами  $p^+$ - $n$ -переходах из высокоомного кремния. 2, 205
- Вербицкая Е. М., Еремин В. К., Иванов А. М., Строкан Н. В. Радиационное воздействие дейтронов на приемники излучения из высокоомного кремния. 7, 1113
- Вербицкая Е. М., Еремин В. К., Иванов А. М., Строкан Н. В., Ли З., Шмидт Б. Роль кислорода в нестабильности углеродсодержащих радиационных дефектов в кремнии. 11/12, 2071
- Вербицкая Е. М., Еремин В. К., Маляренко А. М., Строкан Н. В., Суханов В. Л., Шмидт Б., Борани И. Прецизионная полупроводниковая спектрометрия ионов. 11/12, 2055

- Кукулина К. И., Ирха В. И., Шнайдер И. П. Увеличение фотопроводимости в магнитном поле. 4, 712
- Вилландер М., см. Ивченко Е. Л. 9, 1561
- Винник Е. В., Глинчук К. Д., Гурошев В. И., Прохорович А. В. О природе индуцируемых радиационно-термическим воздействием центров люминесценции в  $p$ -GaAs(Zn). 4, 610
- Винник Е. В., Глинчук К. Д., Гурошев В. И., Прохорович А. В. О механизме радиационно-стимулированных изменений положения максимума полос «применной» люминесценции в арсениде галлия и фосфиде индия. 5, 841
- Винник Е. В., Глинчук К. Д., Гурошев В. И., Прохорович А. В. О причинах различия дозовых зависимостей интенсивности различных полос люминесценции в облученных быстрыми частицами полупроводниковых соединениях  $A^{III}B^V$ . 6, 1030
- Вирт И. С., см. Андрухив М. Г. 11/12, 1863
- Владимирова Е. В., Гусятников В. Н., Журавлев К. А., Иванченко В. А., Павлов В. Г. Влияние глубоких уровней на эффекты поля в гомогенных периодических полупроводниковых структурах на основе кремния. 8, 1400
- Власенко А. И., см. Артамонов В. В. 2, 228
- Власенко А. И., см. Бабенцов В. Н. 10, 1599
- Власенко А. И., см. Бабенцов В. Н. 10, 1618
- Власенко А. И., см. Байдуллаева А. 1, 56
- Власенко А. И., см. Мозоль П. Е. 11/12, 1820
- Власов Ю. А., см. Астратов В. Н. 7, 1101
- Вовк О. В., Лелеченко В. П., Солощенко В. И., Ройзин Я. О., Чкунина В. Н. Влияние термообработки на параметры границы раздела структур Si—SiO<sub>2</sub> после радиационных воздействий. 8, 1349
- Волков Д. А., Фистуль В. И. Метод расчета энергии изовалентных и изоэлектронных примесей в тетраэдрических полупроводниках. 3, 431
- Володько В. Г., см. Галина Т. М. 8, 1379
- Воробьев Л. Е., Данилов С. Н., Донецкий Д. В., Кочегаров Ю. В., Стафеев В. И., Фирсов Д. А. Безынкционный лазер дальнего ИК диапазона на горячих дырках и его использование для исследования примесного пробоя. 1, 146
- Воронина Т. И., см. Баранов А. Н. 3, 421
- Воронина Т. И., Лагунова Т. С., Моисеев К. Д., Сиповская М. А., Тимченко И. Н., Зюковлев Ю. П. Исследование структуры зоны проводимости в твердом растворе InAsSbP. 11/12, 1777
- Воронова И. Д., Горник Е., Клышевич Е. В., Кремсер К., Чеботарев А. П. Длинноволновый край явления остаточной фотопроводимости в  $Pb_{0.78}Sn_{0.22}Te$  с примесью In. 5, 827
- Воротынцева В. М., см. Кузнецов О. А. 10, 1591
- Выграненко Ю. К., Слынько В. В., Слынько Е. И. Глубокие состояния в твер-
- дых растворах  $Pb_{1-x}Sn_xTe$ , легированных галлием. 8, 1387
- Гавалешко Н. Н., Тетеркин В. В., Сизов Ф. Ф., Паранчич С. Ю. Параметры зонного спектра, электрофизические и магнитные свойства четверных полупроводников HgCdMnTe. 3, 459
- Гаврикова Т. А., Зыков В. А., Немов С. А. Особенности явления самокомпенсации в пленках PbSe(Tl, Pb<sub>ex</sub>). 2, 200
- Гавриленко В. И., см. Амиров Р. Х. 8, 1297
- Гавричков В. А. Дистория сложного дефекта со слабой связью. 10, 1667
- Гадаев О. А., см. Андрухив А. М. 2, 348
- Гадияк Г. В., Мороков Ю. Н. Квантово-химическое моделирование взаимодействия фтора с поверхностью (111) кремния. 5, 736
- Галиев В. И., Полупанова А. Ф. Спектры энергий и оптического поглощения мелких примесей в полупроводниковой квантовой точке. 7, 1202
- Галина Т. М., Володько В. Г., Демидов Е. С., Подчираева О. В. Ионная имплантация донорной примеси в фосфид индия. 8, 1379
- Галкин И. М., Нефедов А. А., Чапланов В. А., Шипов И. А., Якимов С. С. Рентгенодифракционное исследование границы раздела между кристаллами Hg<sub>1-x</sub>Cd<sub>x</sub>Te и анодными пленками. 2, 239
- Гальперин Ю. М., см. Афонин В. В. 1, 115
- Гальчицкий Л. П., см. Ембергиев Б. 8, 1240
- Гамерник Р. В., см. Гнатенко Ю. П. 10, 1639.
- Гамзаев Д. О., см. Алекперов О. Э. 7, 1180
- Ганиев У., см. Расулов Р. Я. 3, 374
- Ганиев У. У., см. Расулов Р. Я. 4, 635
- Гарбузов Д. З., Гулаков А. Б., Кочнев И. В., Шерняков Ю. М., Халфин В. Б., Явич Б. С. Особенности зависимости от тока эффективности спонтанного излучения лазерных диодов с одиночной квантовой ямой на AlGaAs/GaAs. 10, 1713
- Гасан-заде С. Г., Богобоющийся В. В., Жадько И. П., Зинченко Э. А., Шепельский Г. А. Особенности температурных и спектральных характеристик фотопроводимости и фотоманнитного эффекта в  $p$ -Cd<sub>x</sub>Hg<sub>1-x</sub>Te при низких температурах. 9, 1508
- Гасан-заде С. Г., Шепельский Г. А. Рекомбинационные механизмы и кинетические явления в односно-напряженном Cd<sub>x</sub>Hg<sub>1-x</sub>Te. 8, 1326
- Гасумянц В. Э., см. Немов С. А. 2, 299
- Гатальский Г. В., см. Федотов В. Г. 4, 551
- Гафурова М. В., см. Урманов Н. А. 9, 1535
- Гафурова М. В., см. Урманов Н. А. 9, 1572
- Георгиц Э. И., см. Цыпишка Д. И. 4, 714
- Гергель В. А., Шпатаковская Г. В. Проводимость инверсионных слоев и температурная зависимость плотности поверхностных состояний в МДП структурах. 6, 923
- Герловин И. Я., см. Абрамов А. П. 7, 1175

- Герчиков Л. Г., Субашиев А. В. Массы дырочных подзон размерного квантования полупроводниковых гетероструктур разной ориентации. 3, 446
- Герчиков Л. Г., Субашиев А. В., Салман Далла. Влияние состава слоев на зонный спектр сверхрешеток типа  $Cd_xHg_{1-x}Te-Cd_yHg_{1-y}Te$ . 1, 60
- Гершензон Е. М., Грачев С. А., Литвак-Горская Л. Б. О роли  $H_2$ -комплексов в оптимизации  $n$ - $InSb$ -смесителей миллиметрового диапазона волн. 9, 1464
- Гинзбург Л. П. Переходы Андерсона в системе  $D^-$ -центров. 1, 30
- Гирич А. В., см. Бакуева Л. Г. 11/12, 1866
- Глазов В. М., Кольцов В. Б. Эффект Холла в расплавах полупроводников с вырожденным электронным газом и его взаимосвязь с электропроводностью и магнитной восприимчивостью. 5, 669
- Глазов В. М., Кольцов В. Б., Куцова В. З., Регель А. Р., Сиротюк С. В., Таран Ю. Н., Фалькевич Э. С. Оценка температуры структурного превращения при нагреве монокристаллов кремния на основе статистической теории растворов и метода псевдопотенциала. 7, 1080.
- Глазов В. М., Пильдон В. И., Зубков А. М., Кольцов В. Б. Исследование электрофизических свойств монокристаллов высокоомного кремния  $n$ -типа проводимости в широком интервале температур. 10, 1605
- Глинчук К. Д., см. Винник Е. В. 4, 610
- Глинчук К. Д., см. Винник Е. В. 5, 841
- Глинчук К. Д., см. Винник Е. В. 6, 1030
- Глинчук К. Д., Гурошев В. И., Прохорович А. В. О зависимости радиационной стойкости интенсивности люминесценции твердых растворов соединений  $A^{III}B^V$  от их состава. 8, 1395
- Глоризова Р. И., Колесник Л. И. Особенности поведения глубоких центров в особом чистом германии. 4, 545
- Гнатенко Ю. П., Фарина И. А., Гамерник Р. В., Крочук А. С., Бабий П. И. Оптические и фотоэлектрические свойства кристаллов  $CdTe:Fe$  и  $Cd_{1-x}Fe_xTe$ . 10, 1639
- Гнатюк В. А., см. Артамонов В. В. 2, 228
- Гнатюк В. А., см. Байдуллаева А. 1, 56
- Гнатюк В. А., см. Мозоль П. Е. 11/12, 1820
- Голикова О. А., Домашевская Э. П., Мавлянов Х. Ю., Терехов В. А., Тростянский С. Н. Плотность дефектов в приповерхностной области слоев аморфного гидрированного кремния. 9, 1468
- Голикова О. А., Икрамов Р. Г., Казанин М. М., Мездрогина М. М. Плотность электронных состояний «собственного» аморфного гидрированного кремния. 3, 465
- Голикова О. А., Икрамов Р. Г., Казанин М. М., Мездрогина М. М. Фотоиндуцированные дефекты в псевдолегированном  $a$ - $Si$ :H. 3, 474
- Голубев В. Г., см. Андреев Б. А. 4, 567
- Гольдман Е. И. Генерация неосновных носителей заряда в электрических полях макроскопических неоднородностей на гра-
- 2, 269
- Горбань С. И., см. Бабенцов В. Н. 3, 504
- Горбань С. И., см. Бабенцов В. Н. 10, 1618
- Горбань И. С., см. Бойко С. И. 5, 815
- Горбылев В. А., Залзвский И. Д., Гершков А. И., Чельный А. А., Аветисян Г. Х., Куликов В. Б., Чукичев В. М., Юнович А. Э. Инфракрасная фотопроводимость и люминесценция квантовых ям в многослойных гетероструктурах  $GaAs/AlGaAs$ . 9, 1453
- Горев Н. Б., Макарова Т. В., Прохоров Е. Ф., Уколов А. Т., Эппель В. И. Глубокие уровни и редукция проводимости прямой гетероструктуры с селективным легированием после подачи отпирающего импульса напряжения на затвор. 6, 996
- Горлин Г. Б. Туланов В. Т. Влияние поверхностного потенциала на образование поверхностного фотографического изображения в  $AgBr$ . 11/12, 1967
- Горник Е., см. Воронова И. Д. 5, 827
- Городилов Н. А., см. Арапов Ю. Г. 7, 1165
- Горячев Д. Н., см. Беляков Л. В. 8, 1371
- Горячев Д. Н., см. Беляков Л. В. 11/12, 1815
- Горячев Д. Н., см. Беляков Л. В. 11/12, 1963
- Градаускас И., см. Ашмонтас С. 7, 1185
- Грачев С. А., см. Гершензон Е. М. 9, 1464
- Гременок В. Ф., см. Киндяк В. В. 7, 1154
- Грехов И. В., см. Берман Л. С. 6, 917
- Грехов И. В., Шулекин А. Ф., Векслер М. И. Статистические характеристики кремниевого оже-транзистора с туннельным МОП эмиттером и индуцированной базой. 1, 88
- Григорчак И. И., см. Нетяга В. В. 7, 1220
- Григорьев С. Р., см. Абрамов А. П. 7, 1175
- Гринев В. И. Краевое излучение в  $ZnSe(Li)$ , облученном электронами. 1, 124
- Грицук Б. Н., Варенко А. И., Сирота А. В., Халаймеда Д. Д. Изменение гальваномагнитных свойств нелегированного антимонида кадмия при естественном старении. 9, 1541
- Грядун В. И., см. Шаповалов В. П. 11/12, 1851
- Гук Е. Г., см. Решина И. И. 5, 728
- Гулаков А. Б., см. Гарбузов Д. З. 10, 1713
- Гулиев Р. А., см. Керимова Т. Г. 8, 1398
- Гулицуц Э., см. Бреслер М. С. 4, 615
- Гуревич Ю. Г., см. Ахизер И. Т. 4, 628
- Гуревич Ю. Г., Логвинов Г. Н., Титов О. Ю. Энергетически неоднородная в пространстве функция распределения электронов в полупроводниковом субмикронном слое. 6, 1040
- Гурошев В. И., см. Винник Е. В. 4, 610
- Гурошев В. И., см. Винник Е. В. 5, 841
- Гурошев В. И., см. Винник Е. В. 6, 1030
- Гурошев В. И., см. Глинчук К. Д. 8, 1395
- Гусев О. Б., см. Бреслер М. С. 4, 615
- Гусейнов Д. Т., см. Керимова Т. Г. 8, 1398
- Гусятников В. Н., см. Владимирова Е. В. 8, 1400
- Гусятников В. Н., Иванченко В. А., Николаев М. В. Особенности фотопроводимости классических сверхрешеток на

- основе  $p$ -Ge в инфракрасном диапазоне 1, 182
- Гуткин А. А., Решиков М. А., Со-  
сновский В. Р. Исследование комплекса  
 $V_{Ga}Sn_{Ga}$  в GaAs методами поляризованной  
фотолюминесценции и пьезоспектроскопии.  
I. Структура комплекса и его переориентация  
при низких одноосных давлениях. 9, 1516
- Гуткин А. А., Решиков М. А., Со-  
сновский В. Р. Исследование комплекса  
 $V_{Ga}Sn_{Ga}$  в GaAs методами поляризованной  
фотолюминесценции и пьезоспектроскопии.  
II. Явление двухступенчатого выстраивания.  
9, 1526
- Гуцев Г. Л., см. Мякенькая Г. С. 1, 67  
Гуцев Г. Л., см. Мякенькая Г. С. 3, 391  
Гуцуляк Л. М., см. Цыпишка Д. И. 4, 714
- Дадабаев О., см. Парицкий Л. Г. 11/12,  
2011
- Далиев Х. С., см. Абдурахманов К. П., 7,  
1222
- Данилов С. Н., см. Воробьев Л. В. 1, 146  
Данишевский А. М., Латинис В., Конь-  
ков О. И., Теруков Е. И., Мездрогина  
М. М., Чусовитин М. С. Поверхностные  
свойства пленок  $\alpha$ -Si: H. 6, 913
- Данченков А. А., Лигачев В. А., Попов  
А. И. Морфология, проводимость и эффект  
псевдолегирования в аморфных и аморфно-  
кристаллических пленках C: H. 8, 1233
- Даулетмуратов Б. К., см. Бабенцов В. Н.  
10, 1618
- Даулетмуратов Б. К., см. Байдуллаева А.  
1, 56
- Дашевский З. М., Руленко М. П. Эффект  
увеличения диффузионной длины носителя  
заряда в поликристаллических пленках  
PbTe. 4, 662
- Двуречанский А. В., Ремесник В. Г.,  
Рязанцев И. А., Галипов Н. Х. Ин-  
версия типа проводимости слоев  $Cd_xHg_{1-x}Te$ ,  
подвергнутых плазменной обработке. 1, 168
- Демидов Е. С., см. Галина Т. М. 8, 1379
- Джумамухамбетов Н. Г., Дмитриев  
А. Г. Температурная зависимость фото-  
люминесценции модифицированных  
кристаллов InP(Sn). 4, 641
- Дидейкин А. Т., Немчук Н. И. Обратные  
тепловые токи в структурах полупро-  
водник—диэлектрик—полупроводник с тон-  
ким диэлектриком. 2, 362
- Дидик В. А., Козловский В. В., Мал-  
кович Р. Ш., Скорятин Е. А. Профили  
изотопов, образованных в полупроводнико-  
вых соединениях  $A^{III}V$  при облучении вы-  
сокоэнергетичными  $\alpha$ -частицами. 2, 265
- Дидик В. А., Козловский В. В., Мал-  
кович Р. Ш., Скорятин Е. А. Профили  
изотопов, созданных в арсениде галлия под  
действием  $\alpha$ -частиц с энергией 12, 16 и  
20 МэВ. 2, 343
- Дидык А. Ю., см. Аль-Баккур Ф. 5, 829
- Дмитриев А. Г. Твердофазное разложение  
GaAs при действии лазерного излучения  
пороговой плотности. 4, 583
- Дмитриев А. Г., см. Джумамухамбетов Н. Г.  
4, 641
- Дмитриева О. Г., см. Артамонов О. М. 10,  
1730
- Дмитриев С. Г., Ждан А. Г., Маркин Ю.  
В. Идентификация многозарядных объемных  
уровней при релаксационной спектроскопии  
границы раздела полупроводник—  
диэлектрик. 8, 1247
- Дмитрук Н. Л., см. Басюк Е. В. 3, 415
- Добровольский В. Н., Нинидзе Г. К.,  
Петрусенко В. Н. Ударная ионизация  
электронов и дырок и лавинной пробой в  
МТДП структурах. 6, 944
- Долговесова И. П., см. Бахтурова Л. Ф. 4,  
588
- Домашевская Э. П., см. Голикова О. А. 9,  
1468
- Домашевская Э. П., см. Терехов В. А. 9,  
1577
- Донецкий Д. В., см. Воробьев Л. Е. 1, 146
- Драбкин И. А., см. Житинская М. К. 10,  
1724
- Дрожжин А. И., см. Антипов С. А. 6, 937
- Дроздов Ю. Н., см. Кузнецов О. А. 10, 1591
- Дроздова И. А., Ембергенов Б., Кор-  
сунская Н. Е., Маркевич И. В. Влияние  
подвижных дефектов на характеристики  
контакта металл—полупроводник в кристал-  
лах CdS. 4, 674
- Дубровский Ю. В., см. Морозов С. В. 9,  
1484
- Дутов А. Г., Комар В. А., Ширяев С. В.  
Примесь алюминия в кремниевых полупро-  
водниковых структурах  $SiO_2$ —Si. 6, 1001
- Евстропов В. В., Жилыев Ю. В., Назар-  
ов Н., Сергеев Д. В., Федоров Л. М.  
Электролюминесценция эпитаксиальных  
GaP  $p$ - $n$ -структур, выращенных на Si-под-  
ложках. 4, 668
- Евстропов В. В., Жилыев Ю. В., Назар-  
ов Н., Сергеев Д. В., Федоров Л. М.,  
Шерняков Ю. М. Электрические свойства  
эпитаксиальных  $p$ - $n$ -структур из GaP на  
Si-подложках. 8, 1319
- Евтушенко О. М., см. Басс Ф. Г. 10, 1741
- Егоров А. Ю., см. Иванов Ю. Л. 11/12, 2080
- Лангер Ежи И., см. Рыскин А. И. 8, 1369
- Ембергенов Б., см. Дроздова И. А. 4, 674
- Ембергенов Б., Корсунская Н. Е.,  
Рыжиков В. Д., Гальчинецкий Л. П.,  
Лисецкая Е. К. Структура центров све-  
чения в кристаллах ZnSe. 8, 1240
- Емцев В. В., см. Андреев Б. А. 4, 567
- Емцев В. В., Машовец Т. В., Михнович  
В. В. Аннигиляция пар Френкеля в полу-  
проводниках. 4, 708
- Емцев В. В., Машовец Т. В., Оганесян  
Г. А., Шмальц К. Образование двойных  
термодоноров в Cz—Si с различной концен-  
трацией кислорода. 9, 1545
- Емцев В. В., Оганесян Г. А., Шмальц К.  
Критическая концентрация кислорода в Cz—  
Si и кластеризация примесных атомов при  
термообработке. 9, 1549

- Емцев В. В., Оганесян Г. А., Шмальц К. «Новые доноры» в термообработанном кремнии с изозлектронной примесью германия. 11/12, 2024
- Еремин В. К., см. Вербицкая Е. М. 2, 205
- Еремин В. К., см. Вербицкая Е. М. 7, 1113
- Еремин В. К., см. Вербицкая Е. М. 11/12, 2055
- Еремин В. К., см. Вербицкая Е. М. 11/12, 2071
- Жадько И. П., см. Гасан-заде С. Г. 9, 1508
- Жалко-Титаренко И. В., Крайчинский А. Н., Осташко Н. И., Рогущкий И. С. Образование дефектов в кремнии в диапазоне температур 10—300 К при электронном облучении. 10, 1698
- Ждан А. Г., см. Дмитриев С. Г. 8, 1247
- Ждан А. Г., Лифшиц Т. М., Рыльков В. В., Шафран А. Г. Резонансы в температурной зависимости электропроводности легированного кремния, обусловленные возбужденными состояниями примеси. 5, 845
- Жданович Н. С., см. Конорова Л. Ф. 3, 470
- Железняк А. Т., см. Шмелев Г. М. 7, 1224
- Жиляев Ю. В., см. Беркелиев А. 10, 1624
- Жиляев Ю. В., см. Евстропов В. В. 4, 668
- Жиляев Ю. В., см. Евстропов В. В. 8, 1319
- Жиляев Ю. В., Назаров Н., Рудь В. Ю., Рудь Ю. В., Федоров Л. М. Поляризационная фоточувствительность эпитаксиальных GaP-структур на Si-подложках. 10, 1611
- Житинская М. К., см. Немов С. А. 2, 299
- Житинская М. К., Немов С. А., Равич Ю. И., Абайдулина Т. Г., Компанец В. В., Бушмарина Г. С., Дранбик И. А. Электрофизические свойства теллурида висмута, легированного индием. 10, 1724
- Жуков А. Е., см. Иванов Ю. Л. 11/12, 2080
- Жуков А. И., см. Ковтун Г. П. 6, 1025
- Жуковский П. В. Явление самовосстановления структуры имплантируемых полупроводников. 5, 789
- Журавлев К. А., см. Владимиров Е. В. 8, 1400
- Журавлев К. С., Якушева Н. А., Шамирзаев Т. С., Погадаев В. Г., Шегай О. А. Влияние легирования галлием висмутового раствора-расплава на остаточные примеси в эпитаксиальном GaAs. 9, 1473
- Забродский А. Г., Алексеенко М. В. Исследование кинетики нейтронного легирования германия: характеристика материала и определение ядерно-физических постоянных. 11/12, 2033
- Зайнабидинов С. З., см. Абдураимов А. 3, 516
- Зайнабидинов С. З., см. Абдураимов А. 7, 1216
- Закиров А. С., Игамбердыев Х. Т., Мамадалимов А. Т., Хабибуллаев П. К. Особенности температурной зависимости фотопроводимости кремния, легированного золотом. 9, 1556
- Закиров Н., см. Ахизер И. Т. 4, 628
- Залевский И. Д., см. Горбылев В. А. 9, 1453
- Засавицкий И. И., см. Трофимов В. Т. 7, 1158
- Захаренков Л. Ф., см. Козловский В. В. 2, 345
- Захарова Н. Б., см. Казакова Л. П. 6, 959
- Звонков Б. Н., см. Алешкин В. Я. 6, 931
- Звонков Б. Н., см. Карпович И. А. 10, 1736
- Звягин И. П. Рекомбинация через комплекс оборванных связей в аморфном кремнии. 11/12, 1857
- Звягин И. П., Курова И. А., Ормонт Н. Н. О природе фотоиндуцированных дефектов в аморфном гидрированном кремнии. 10, 1707
- Зейналлы А. Х., см. Лебедева Н. Н. 7, 1134
- Зильберман А. Б., см. Андреева Е. В. 7, 1095
- Зимин С. П., Корегина Е. Л., Бочкарева Л. В. Свойства компенсированных пленок в системе сульфид свинца—сульфид кадмия. 1, 185
- Зингер Г. М., см. Васильев А. В. 8, 1305
- Зинченко Э. А., см. Гасан-заде С. Г. 9, 1508
- Зломанов В. П., см. Лашкарев Г. В. 6, 1067
- Знаменский Д. А., см. Антоненко В. И. 2, 221
- Зотова А. С., см. Берил С. И. 1, 12
- Зотова Н. В., см. Айдаралиев М. 1, 21
- Зу Н., см. Ивченко Е. Л. 9, 1561
- Зубков А. М., см. Глазов В. М. 10, 1605
- Зув В. В., см. Никитин А. Г. 7, 1211
- Зушинский Д. А., см. Бер Б. Я. 9, 1480
- Зыков В. А., см. Гаврикова Т. А. 2, 200
- Зыков Г. А., см. Лашкарев Г. В. 8, 1381
- Ибрагимова М. И., Петухов В. Ю., Хайбуллин И. Б. Радиационное распухание и распыление  $Cd_xHg_{1-x}Te$  при имплантации ионов в больших дозах. 4, 560
- Ибрагимова М. И., Файзрахманов И. А., Хайбуллин И. Б., Саинов Н. А. Трансформация кристаллической структуры  $Cd_xHg_{1-x}Te$  при ионной имплантации. 8, 1276
- Иваницкая О. И., Матвеев О. А., Томасов А. А., Яковлев Н. В. Формирование энергетического спектра монокристаллического рентгеновского излучения при неоднородном поглощении в полупроводниковых детекторах. 11/12, 1885
- Иванов А. М., см. Берман Л. С. 11/12, 1795
- Иванов А. М., см. Вербицкая Е. М. 2, 205
- Иванов А. М., см. Вербицкая Е. М. 7, 1113
- Иванов А. М., см. Вербицкая Е. М. 11/12, 2071
- Иванов-Омский В. И., см. Андрухив А. М. 2, 348
- Иванов-Омский В. И., см. Цыпишка Д. И. 4, 714
- Иванов П. А., см. Аникин М. М. 1, 102
- Иванов П. А., Пентелеев В. Н., Самсонова Т. П., Суворов А. В., Челноков В. Е. МОП конденсатор на основе



- термическое окисленное  $n$ -6H—SiC (0001)C 7, 1146
- Иванов Ю. Л., Васильев Ю. Б., Сучалкин С. Д. Субмиллиметровая спектроскопия объемных полупроводников и полупроводниковых структур с пониженной размерностью с помощью плавно перестраиваемого германиевого циклотронного лазера. 11/12, 1997
- Иванов Ю. Л., см. Сучалкин С. Д. 11/12, 2078
- Иванов Ю. Л., Чураков Г. В., Копьев П. С., Устинов В. М., Егоров А. Ю., Жуков А. Е. Возгорание горячей люминесценции квантовых ям в сильном магнитном поле. 11/12, 2080
- Иванченко В. А., см. Владимирова Е. В. 8, 1400
- Иванченко В. А., см. Гусятников В. Н. 1, 182
- Иванчик И. И., см. Акимов Б. А. 2, 351
- Ивченко Е. Л., см. Алейнер И. Л. 4, 594
- Ивченко Е. Л., Киселев А. А., Зу Н., Вилландер М. Бистабильность туннельного тока и фотолюминесценция в трехбарьерной структуре. 9, 1561
- Игамбердыев Х. Т., см. Закиров А. С. 9, 1556
- Игнатьев И. В., см. Абрамов А. П. 7, 1175
- Игнатьев А. С., Каменев А. В., Копылов В. Б., Немцев Г. З., Посвянский Д. В. Исследование статистических вольт-амперных характеристик резонансно-туннельных диодов на основе гетероструктур GaAs/AlAs. 5, 775
- Икрамов Р. Г., см. Голикова О. А. 3, 465
- Икрамов Р. Г., см. Голикова О. А. 3, 474
- Ильин Ю. Л., см. Андреева Е. В. 7, 1095
- Ильин В. И., см. Бакуева Л. Г. 11/12, 1866
- Ильин В. И., см. Бакуева Л. Г. 11/12, 1868
- Ильинская Н. Д., Кохановский С. И., Сейсян Р. П. Осциллирующее магнитопоглощение многослойных квантово-размерных структур. 1, 108
- Имамкулиев С. Д., см. Мусихин С. Ф. 3, 513
- Иновенков А. Н., Константинов О. В., Пирогов В. И. Спектр токового шума микроплазмы при высокоимпедансном включении диода. 6, 951
- Ипатова И. П., Малышкин В. Г., Маслов А. Ю., Шукин В. А. Образование периодических структур с модулированным составом при когерентном разделении фаз в четверных твердых растворах полупроводников  $A^{III}B^V$ . 2, 285
- Ипатова И. П., Пршнина О. В., Шукин В. А. Двумерно-периодическая доменная структура сегнетоэлектрического включения в матрице. 11/12, 1873
- Ирха В. И., см. Викулина К. И. 4, 712
- Исаев А. И., см. Казакова Л. П. 6, 959
- Ишмуратов Г. В., см. Муминов Р. А. 2, 250
- Кабалдин А. Н., см. Неймаш В. Б. 10, 1651
- Кабанов В. Ф., Свердловва А. М. Исследование фотомангнитных свойств пленок Кабулов Р. Р., см. Аронов Д. А. 6, 1014
- Кавалюскас Ю., Кривайте Г., Шилейка А. Модуляционные спектры структур легированных квантовых ям GaAs—Al<sub>0.3</sub>Ga<sub>0.7</sub>As. 7, 1086
- Кавокин А. В., Несвижский А. И., Сейсян Р. П. Экситон в полупроводниковой квантовой яме и сильном магнитном поле. 6, 977
- Кадушкин В. И. Фотомангнитный эффект  $n$ -JnSb в сильном электрическом и квантующем магнитном полях. 5, 808
- Кадушкин В. И., Шангина Е. Л. Явление переноса в легированных сверхрешетках GaAs/Al<sub>x</sub>Ga<sub>1-x</sub>As разнесенного типа. 8, 1311
- Казакевич Л. А., Колковский И. И., Кузнецов В. И., Лугаков П. Ф., Салманов А. Р. Эффективность образования радиационных дефектов в  $p$ -кремнии, выращенном с использованием магнитного поля. 10, 1680
- Казакевич Л. А., Кузнецов В. И., Лугаков П. Ф., Салманов А. Р. Влияние примесей переходных металлов на накопление радиационных дефектов в  $p$ -кремнии. 3, 478
- Казакевич Л. А., Кузнецов В. И., Лугаков П. Ф., Салманов А. Р., Прокофьева В. К. Особенности образования и отжига радиационных дефектов в  $p$ -кремнии, легированном цирконием. 3, 535
- Казакова Л. П., Лебедев Э. А., Исаев А. И., Мехтиева С. И., Захарова Н. Б., Ятлинко И. И. Влияние примесей галогенов на перенос носителей заряда в стеклообразных полупроводниках системы Se—As 6, 959
- Казанин М. М., см. Голикова О. А. 3, 465
- Казанин М. М., см. Голикова О. А. 3, 474
- Казанский А. Г., Шамонина Е. А. Влияние легирования на фотопроводимость  $\alpha$ -Si : H. 10, 1688
- Казанский А. Г., Яркин Д. Г. Влияние уровня легирования и температуры на эффект Стеблера—Вронского в пленках  $\alpha$ -Si : H, легированных фосфором. 10, 1693
- Калинкин И. П., см. Беляев А. П. 3, 527
- Калиновский В. С., см. Андреев В. М. 1, 141
- Калиновский В. С., см. Андреев В. М. 1, 156
- Калинушкин В. П., Юрьев В. А. Изменение диаграммы рассеяния света монокристаллами нелегированного GaAs вследствие электронного облучения. 1, 188
- Калинушкин В. П., Юрьев В. А., Мушин Д. И., Плоппа Н. Г., Тиме Т. В. Влияние процесса газофазной эпитаксии на скопления электрически активных дефектов в подложках из GaAs(Cr). 3, 538
- Каллион Р. В., см. Андреев В. М. 1, 141
- Калугин С. М., см. Антоненко В. И. 2, 221
- Каменев А. В., см. Игнатьев А. С. 5, 775
- Канцер В. Г., Малкова Н. М. Приграничные электронные состояния в полу-

- проводниковых (IV—VI) сверхрешетках. 10, 1585
- Каражанов С. Ж., см. Саидов А. С. 2, 256
- Карандолиев С. А., см. Айдаралиев М. 1, 21
- Кардона М., см. Мирлин Д. Н. 6, 990
- Каримов И. Н., см. Берман Л. С. 6, 917
- Каримов М., см. Юнусов М. С. 7, 1130
- Каримов О. З., см. Абрамов А. П. 7, 1175
- Карлес Р., см. Кузнецов О. А. 10, 1591
- Карпенко В. П., Матвеев О. А. Исследование CdTe-детекторов для вычислительной рентгеновской томографии. 11/12, 1904
- Карпов В. Г., Субашиев А. В. Флуктуационные состояния в полупроводниковых твердых растворах с вырожденными зонами. 5, 884
- Карпович И. А., см. Алешкин В. Я. 8, 1344
- Карпович И. А., Бедный Б. И., Байдусь Н. В., Батукова Л. М., Звонков Б. Н., Степихова М. В. Гетероэпитаксиальная пассивация поверхности GaAs. 10, 1736
- Карягин С. Н., Константинова Е. А., Лупачева А. Н. Исследование влияния освещения на свойства парамагнитных дефектов в пленках аморфного гидрогенизированного карбида кремния переменного состава. 7, 1227
- Касаткин А. П., см. Тетельбаум Д. И. 10, 1657
- Катков В. Ф., см. Мекекечко А. Ю. 6, 1060
- Качурин Г. А., Тыщенко И. Е. Поведение бора и азота в приповерхностном слое кремния при синтезе захороненных слоев имплантацией ионов. 7, 1194
- Керимова Т. Г., Гусейнов Д. Т., Гулиев Р. А., Мамедова И. А., Бабаев Т. Р. Оптические свойства твердых растворов  $CdGa_2S_4xSe_4(1-x)$ . 8, 1398
- Кесаманлы Ф. П., Рудь Ю. В. Полупроводники II—IV—V<sub>2</sub>. 11/12, 1761
- Киндяк А. С., см. Киндяк В. В. 7, 1154
- Киндяк В. В., Киндяк А. С., Гременюк В. Ф., Боднарь И. В., Рудь Ю. В., Медведкин Г. А. Оптические константы лазерноосажденных пленок  $CuGaSe_2$  вблизи фундаментального края поглощения. 7, 1154
- Киселева А. А., см. Ивченко Е. Л. 9, 1561
- Кисин М. В. Феноменологический анализ граничных условий для волновой функции модели Кейна. 3, 488
- Кислый В. П., см. Болгов С. С. 1, 171
- Кладыко В. П., см. Семенова Г. Н. 1, 162
- Клышевич Е. В., см. Воронова И. Д. 5, 827
- Клюканов А. А., Балмуш Н. И. Поглощение инфракрасного излучения электронной плазмой при рассеянии на примесях и плазмон-фононных возбуждениях в полупроводниках. 4, 655
- Кнапп В., см. Смирнов Д. В. 10, 1631
- Ковалев Д. И., см. Андрианов А. В. 1, 136
- Ковалевская Г. Г., см. Слободчиков С. В. 7, 1213
- Коваленко А. В., см. Берлов П. А. 7, 1121
- Коваленко А. В., Бочкова Т. М. Детекторы ионизирующего излучения на структуре скинтиллятор (подложка) — планарный фотоприемник  $ZnSe_xTe_{1-x}-ZnSe$ . 8, 1335
- Коваленко А. В., см. Мекекечко А. Ю. 6, 1060
- Ковалюк З. Д., см. Нягяга В. В. 7, 1220
- Ковалюк М. З., см. Кульбачинский В. А. 4, 677
- Ковтун Г. П., Кравченко А. И., Жуков А. И., Стерлев А. Н., Шербань А. П. Расчет температурных полей в монокристаллах GaAs, выращиваемых в тонком слое расплава методом Киропулоса с жидкостной герметизацией. 6, 1025
- Ковтун Р. Н., см. Яфасов А. М. 5, 762
- Козлов В. А., см. Болотов Л. Н. 8, 1375
- Козлов И. П., см. Аль-Баккур Ф. 5, 829
- Козловский В. В., см. Дидик В. А. 2, 265
- Козловский В. В., см. Дидик В. А. 2, 343
- Козловский В. В., Захаренков Л. Ф. Компенсация проводимости  $n$ -GaAs(Yb) радиационными дефектами. 2, 345
- Козырев С. В., Роткин В. В. Фуллерен. Строение, динамика кристаллической решетки, электронная структура и свойства (обзор). 9, 1409
- Колесник Л. И., см. Глориозова Р. И. 4, 545
- Колесник С. П., см. Лашкарев Г. В. 8, 1381
- Коллин Н. Г., см. Брудный В. Н. 2, 260
- Колковский И. И., см. Казакевич Л. А. 10, 1680
- Колчанова Н. М., см. Богословская А. Б. 9, 1574
- Кольцов В. Б., см. Глазов В. М. 5, 669
- Кольцов В. Б., см. Глазов В. М. 7, 1080
- Кольцов В. Б., см. Глазов В. М. 10, 1605
- Кольченко Т. И., Коява В. Т., Ломако В. М. Диагностика пленок арсенида галлия, выращенных методом атомно-слоевой эпитаксии. 5, 822
- Комар В. А., см. Дутов А. Г. 6, 1001
- Компанец В. В., см. Житинская М. К. 10, 1724
- Конников С. Г., Мелебаев Д., Рудь Ю. В. Поляриметрический эффект в  $GaP_xAs_{1-x}$  поверхностно-барьерных структурах. 5, 757
- Конорова Л. Ф., Жданович Н. С. Влияние нейтронного облучения на инфракрасное поглощение в стеклообразном трисульфиде мышьяка. 3, 470
- Константинов О. В., см. Иновенков А. Н. 6, 951
- Константинова Е. А., см. Карягин С. Н. 7, 1227
- Константинова Н. Н., Магомедов М. А., Рудь Ю. В. Фоточувствительность гетеропереходов  $n$ - $Cd_{0,8}Zn_{0,2}S$ — $p$ - $CuInSe_2$ . 5, 835
- Коньков О. И., см. Данишевский А. М. 6, 913
- Копишинская Е. П., см. Мозоль П. Е. 11/12, 1820
- Копьев П. С., см. Иванов Ю. Л. 11/12, 2080
- Копылов В. Б., см. Игнатьев А. С. 5, 775
- Корегина Е. Л., см. Зимин С. П. 1, 185
- Корженевский А. Л. Спектр возбужденный разупорядоченного кристалла  $A_xA'_{1-x}B$  с концентрацией изотопической примеси, близкой к порогу протекания. 5, 889
- Корняков О. В., см. Бер Б. Я. 9, 1480
- Корольков В. И., см. Абашкина С. А. 6, 966
- Корсунская Н. Е., см. Дроздова И. А. 4, 674

- Орсунская Н. Е., см. Ембергенос В. Б., 1240  
 Корытцев С. В., см. Семенова Г. Н. 1, 162  
 Костин И. В., Осипов Е. Б., Осипова Н. А. Константы деформационного потенциала глубоких акцепторов в модели короткодействующего потенциала центра. 10, 1743  
 Контюченко В. Я., см. Студеникин С. А. 5, 744  
 Котов Г. И., см. Сысоев Б. И. 1, 131  
 Кохановский С. И., см. Ильинская Н. Д. 1, 108  
 Кочерагов Ю. В., см. Воробьев Л. Е. 1, 146  
 Кочнев И. В., см. Гарбузов Д. З. 10, 1713  
 Козн Е., см. Ашкинадзе Б. М. 11/12, 1953  
 Коява В. Т., см. Кольченко Т. И. 5, 822  
 Кравченко А. И., см. Ковтун Г. П. 6, 1025  
 Крайчинский А. Н., см. Жалко-Гитаренко И. В. 10, 1698  
 Красильник З. Ф., см. Алешкин В. Я. 7, 1190  
 Краснобаев Л. Я., см. Омеляновская Н. М. 4, 544  
 Краснов А. Н., Ваксман Ю. Ф., Пуртов Ю. Н. Диффузия лития в  $p$ -ZnSe. 3, 511  
 Кремсер К., см. Воронова И. Д. 5, 827  
 Крещук А. М., см. Бастулов С. Д. 4, 645  
 Криваяте Г., см. Кавалюкас Ю. 7, 1086  
 Криволапчук В. В., см. Акимов А. В. 2, 310  
 Кропотов Г. И., см. Андреев Б. А. 4, 567  
 Крохмаль А. П., см. Бойко С. И. 5, 815  
 Крочук А. С., см. Гнатенко Ю. П. 10, 1639  
 Крыштаб Т. Г., см. Семенова Г. Н. 1, 162  
 Кудряшов Н. А., см. Бутусов Д. М. 2, 214  
 Кудряшов Н. А., Кучеренко С. С., Фетисов Н. В. Расчет динамики фототклика диодов с резким переходом при высоких уровнях фотовозбуждения. 2, 358  
 Кузнецов В. И., см. Казакевич Л. А. 3, 478  
 Кузнецов В. И., см. Казакевич Л. А. 3, 535  
 Кузнецов В. И., см. Казакевич Л. А. 10, 1680  
 Кузнецов В. С., Бочкарева Л. В. О механизме тока в тонкопленочных монокристаллических  $p$ - $n$ -переходах на основе PbS. 5, 785  
 Кузнецов Н. И. Токовая релаксационная спектроскопия глубоких уровней (i-DLTS). 10, 1674  
 Кузнецов О. А., см. Арапов Ю. Г. 7, 1165  
 Кузнецов О. А., Орлов Л. К., Дроздов Ю. Н., Воротынцев В. М., Мильвидский М. Г., Вдовин В. И., Карлес Р., Ланда Г. Сверхрешетки Ge—Ge<sub>1-x</sub>Si<sub>x</sub>, полученные гидридным методом. 10, 1591  
 Кузьма М., см. Валь А. 4, 622  
 Кулеев И. Г., Леринман Н. К., Ляпинин И. И., Сабирзянова Л. Д., Цидильковский И. М. Почему постоянна подвижность электронов в HgSe:Fe при низких температурах? 3, 519  
 Кулибеков А. М., см. Алекперов О. Э. 7, 1180  
 Кулибеков А., Фишер Р., Аллахвердиев К., Хаарер Д. Двухфотонное поглощение пикосекундных лазерных импульсов в слоистом GeS. 7, 1229  
 Куликов В. Б., см. Горбылев В. А. 9, 1453  
 Куликов Г. С., см. Абдурахманов К. П. 7, 1222  
 Куликов Г. С., Мездрогина М. М., Першеев С. К., Абдурахманов К. П. Аморфный гидрированный кремний, легированный диспрозием. 8, 1389  
 Куликов Г. С., Мездрогина М. М., Першеев С. К. Диффузионное легирование се-ребром аморфного гидрированного кремния с примесью бора. 8, 1392  
 Кульбачинский В. А., Ковалюк М. З., Пырляев Н. Н. Влияние интеркаляции Li и Ва на электрофизические свойства InSe. 4, 677  
 Курбанова У. Х., см. Бахадырханов М. К. 10, 1684  
 Курбатов В. А., см. Асланов Г. А. 2, 277  
 Курова И. А., см. Звягин И. П. 10, 1707  
 Куцова В. З., см. Глазов В. М. 7, 1080  
 Кучеренко С. С., см. Бутусов Д. М. 2, 214  
 Кучеренко С. С., см. Кудряшов Н. А. 2, 358  
 Кучинский П. В., Ломако В. М., Петрунин А. П., Патракеев С. П., Суриков И. Н., Шахлевич Л. Н. Влияние нитридации на радиационное изменение электрофизических свойств МДП структур на основе кремния. 8, 1354  
 Кязым-заде А. Г. Теория протекания и переход Мотта в легированных полупроводниках. 4, 717  
 Лагунова Т. С., см. Баранов А. Н. 3, 421  
 Лагунова Т. С., см. Воронина Т. И. 11/12, 1777  
 Ланда Г., см. Кузнецов О. А. 10, 1591  
 Ларкин И. А., Ханин Ю. Н. Когерентное и последовательное туннелирование в резонансно-туннельном диоде со спейсером. 11/12, 1800  
 Латинис В., см. Данишевский А. М. 6, 913  
 Лашкарев Г. В., Бродовой А. В., Мирец А. Л., Зломанов В. П., Малеванная О. И. Магнитная восприимчивость твердых растворов Pb<sub>1-x</sub>Mn<sub>x</sub>Te. 6, 1067  
 Лашкарев Г. В., Бродовой А. В., Мирец А. Л., Колесник С. П., Зыков Г. А., Никитин М. С. Магнитные свойства чистых и легированных индием монокристаллов Cd<sub>0.2</sub>Hg<sub>0.8</sub>Te при низких температурах. 8, 1381  
 Лебедев А. А., см. Абдурахманов К. П. 7, 1222  
 Лебедев А. А., Ременюк А. Д., Рудь Ю. В. Температурная зависимость стационарной фотолуминесценции пористого кремния в видимой области спектра. 11/12, 1846  
 Лебедев А. А., Экке В. Определение энергетического спектра плотности поверхностных состояний в МДП структурах с помощью емкостной спектроскопии DLTS при учете взаимодействия с несносными носителями тока. 1, 76  
 Лебедев Э. А., см. Казакова Л. П. 6, 959  
 Лебедева Н. Н., Орбух В. И., Зейналлы А. Х. Визуализация электрических неоднородностей в полупроводниках. 10, 1684

- родностей в полупроводнике арсениде галлия. 7, 1134
- Леванович В. Н., см. Антоненко В. И. 2, 221
- Левин М. Н., Литманович В. И., Татаринцев А. В., Чернышев В. Е. Прямой метод определения плотности поверхностных состояний по токам накачки заряда. 1, 3
- Левинштейн М. Е. Рецензия на книгу К. Ли и др. «Моделирование полупроводниковых приборов для Сверхбольших Интегральных Схем (СБИС)». 3, 542
- Лейдерман А. Ю., см. Саидов А. С. 2, 256
- Лелеченко В. П., см. Вовк О. В. 8, 1349
- Леотен Ж., см. Смирнов Д. В. 10, 1631
- Леринман Н. К., см. Кулеев И. Г. 3, 519
- Ле Туан, см. Бер Б. Я. 9, 1480.
- Ле Туан, Новиков С. В., Савельев И. Г., Шелковников Д. Н., Шмарцев Ю. В. Легирование эпитаксиальных слоев GaAs акцепторной примесью Zn при жидкофазной эпитаксии из растворов-расплавов Ga—Bi. 6, 1007
- Ли З., см. Вербицкая Е. М. 11/12, 2071
- Лигачев В. А., см. Данченко А. А. 8, 1233
- Лигачев В. А., см. Сулеман Х. 2, 338
- Линьков Е. Р., см. Алешкин В. Я. 6, 931
- Лисецкая Е. К., см. Ембергенов Б. 8, 1240
- Литвак-Горская Л. Б., см. Банная В. Ф. 10, 1661
- Литвак-Горская Л. Б., см. Гершензон Е. М. 9, 1464
- Литманович В. И., см. Левин М. Н. 1, 3
- Лифшиц Т. М., см. Ждан А. Г. 5, 845
- Логвинов Г. Н., см. Гуревич Ю. Г. 6, 1040
- Ломако В. М., см. Кольченко Т. И. 5, 822
- Ломако В. М., см. Кучинский П. В. 8, 1354
- Лончаков А. Т., см. Матвеев Г. А. 3, 409
- Лугаков П. Ф., см. Казакевич Л. А. 3, 478
- Лугаков П. Ф., см. Казакевич Л. А. 3, 535
- Лугаков П. Ф., см. Казакевич Л. А. 10, 1680
- Луговая Г. Я., см. Банная В. Ф. 10, 1661
- Лукьяненко В. И., см. Мозоль П. Е. 11/12, 1820
- Лупачева А. Н., см. Карягин С. Н. 7, 1227
- Ляпинин И. И., см. Кулеев И. Г. 3, 519
- Мавлянов Х. Ю., см. Голикова О. А. 9, 1468
- Магомедов М. А., см. Константинова Н. Н. 5, 835
- Магомедов М. А., Рудь Ю. В. Фотоэлектрические свойства гетеропереходов  $n$ -CdS(In)— $p$ -CuInSe<sub>2</sub>. 2, 245
- Маева О. И., см. Басюк Е. В. 3, 415
- Макаренко И. В., см. Болотов Л. Н. 8, 1375
- Макарова Т. В., см. Горев Н. Б. 6, 996
- Макарова Т. Л., Шаронова Л. В., Шмарцев Ю. В. Эллисометрическое исследование анодного окисла на твердых растворах Ga<sub>1-x</sub>Al<sub>x</sub>As. 11/12, 1830
- Малаева В. Т., см. Муминов Р. А. 2, 250
- Малеванная О. И., см. Лашкарев Г. В. 6, 1067
- Малевиц В. Л. О перегретной оптической бистабильности в дырочных полупроводниках. 1, 176
- Малкова Н. М. см. Канцер В. Г. 10, 1585
- Малкович Р. Ш. см. Дидик В. А. 2, 265
- Малкович Р. Ш. см. Дидик В. А. 2, 343
- Малышев В. А., Сапелкин С. В., Червяков Г. Г., Юхимец Е. А. Нелинейные преобразования сигнала модуляции света при квадратичной рекомбинации в фотоприемнике. 1, 179
- Малышкин В. Г. см. Ипатов А. П. 2, 285
- Малышкин В. Г. Шукин В. А. Развитие неоднородностей состава при послонном росте эпитаксиальной пленки твердого раствора полупроводников A<sup>III</sup>B<sup>V</sup>. 11/12, 1932
- Малютенко В. К., см. Болгов С. С. 1, 171
- Малыренко А. М., см. Вербицкая Е. М. 11/12, 2055
- Мамадалимов А. Т., см. Закиров А. С. 9, 1556
- Маматкаримов О. О., см. Абдураимов А. 3, 516
- Маматкаримов О. О., см. Абдураимов А. 7, 1216
- Маматкулов Р., см. Аронов Д. А. 6, 1014
- Мамедова И. А., см. Керимова Т. Г. 8, 1398
- Маняхин Ф. И., см. Богословская А. Б. 9, 1574
- Маргулис А. Д., Маргулис Вл. А. Магнитоэлектрический эффект в бесщелевых полупроводниках I рода. 2, 323
- Маргулис Вл. А. см. Маргулис А. Д. 2, 323
- Маркевич В. П., см. Мурин Л. И. 2, 193
- Маркевич И. В., см. Дроздова И. А. 4, 674
- Маркин Ю. В., см. Дмитриев С. Г. 8, 1247
- Маслов А. Ю., см. Ипатов А. П. 2, 285
- Мастеров В. Ф. Электронная структура примесей редкоземельных элементов в соединениях A<sup>III</sup>B<sup>V</sup> (обзор). 9, 1435
- Матвеев Б. А., см. Айдаралиев М. 1, 21
- Матвеев Г. А., Лончаков А. Т. Неомическая проводимость Ge : Sb вблизи перехода металл—изолятор. 3, 409
- Матвеев О. А., см. Иванцкая О. И. 11/12, 1885
- Матвеев О. А., см. Карпенко В. П. 11/12, 1904
- Матвеев О. А., Терентьев А. И. Самокомпенсация в области собственной проводимости CdTe(Cl) в условиях двухфазного равновесия системы кристалл—газ. 11/12, 1894
- Махин А. В., см. Андреева Е. В. 7, 1095
- Машовец Д. В., см. Смирнов Д. В. 10, 1631
- Машовец Т. В., см. Емцев В. В. 4, 708
- Машовец Т. В., см. Емцев В. В. 9, 1545
- Медведкин Г. А., см. Киндяк В. В. 7, 1154
- Мездрогина М. М., см. Голикова О. А. 3, 465
- Мездрогина М. М., см. Голикова О. А. 3, 474
- Мездрогина М. М., см. Данишевский А. М. 6, 913
- Мездрогина М. М., см. Куликов Г. С. 8, 1389
- Мездрогина М. М., см. Куликов Г. С. 8, 1392
- Мекекечко А. Ю., Коваленко А. В., Черненко И. М., Катков В. Ф. Исследование чувствительности к водороду структур ZnSe/GaAs. 6, 1060

- Мелебаев Д., см. Конников С. Г. 5, 757  
 Мескида-Кюстерс А., см. Аверин С. В. 11/12, 1811  
 Мехтиева С. И., см. Казакова Л. П. 6, 959  
 Миланова М. М., см. Андреев В. М. 1, 156  
 Мильвидский М. Г., см. Кузнецов О. А. 10, 1591  
 Миляев В. А., Никитин В. А., Ширков А. В. Картирование времени жизни неравновесных носителей в кремниевых пластинах со структурой из алюминиевых полосок. 1, 99  
 Минтаиров А. М., см. Андреев В. М. 1, 156  
 Миргородский В. И., Сабликов В. А., Филатов А. Л. Фоторефрактивный метод бесконтактного определения рекомбинационных характеристик полупроводников. 1, 81  
 Мирец А. Л., см. Лашкарев Г. В. 6, 1067  
 Мирец А. Л., см. Лашкарев Г. В. 6, 1381  
 Мирлин Д. Н., Сапега В. Ф., Сиренко А. А., Кардона М., Плоог К. Энергетическая зависимость параметров поляризации горячей фотолюминесценции в структурах с квантовыми ямами. 6, 990  
 Миронов К. Е., см. Цыпишка Д. И. 4, 714  
 Михнович В. Э., см. Емцев В. В. 4, 708  
 Мозоль П. Е., см. Артамонов В. В. 2, 228  
 Мозоль П. Е., см. Бабенцов В. Н. 10, 1618  
 Мозоль П. Е., см. Байдуллаева А. 1, 56  
 Мозоль П. Е., Гнатюк В. А., Сукач А. В., Власенко А. И., Копшинская Е. П., Лукьяненко В. И. Влияние особенностей структуры эпитаксиальных слоев  $Cd_xHg_{1-x}Te$  на электрические и фотоэлектрические свойства при лазерном облучении. 11/12, 1820  
 Моисеев К. Д., см. Веронина Т. И. 11/12, 1777  
 Моисеев Ю. Н., см. Антоненко В. И. 2, 221  
 Монахов А. М., см. Аверкиев Н. С. 4, 600  
 Морозов С. В., Дубровский Ю. В. Нелинейное поведение осцилляций Шубникова—де-Гааза в сильных электрических полях в короткоканальных  $Al_xGa_{1-x}As/GaAs$ -гетероструктурах. 9, 1484  
 Мороков Ю. Н., см. Гадяк Г. В. 5, 736  
 Мошников В. А., см. Андреев Е. В. 7, 1095  
 Мунинов Р. А., Малаева В. Т., Оксман М. М., Ишмуратов Г. В., Юнусова Х. Влияние структурной неоднородности полупроводника и диэлектрика на зарядовые свойства поверхности МДП структур. 2, 250  
 Мурель А. В., см. Тетельбаум Д. И. 10, 1657  
 Мурель А. В., см. Алешкин В. Я. 6, 931  
 Мурин Д. И., см. Калинушкин В. П. 3, 538  
 Мурин Л. И., Маркевич В. П. О механизме подавления генерации термодонов в кремнии примесными атомами углерода. 2, 193  
 Мусихин С. Ф., см. Бакуева Л. Г. 11/12, 1866  
 Мусихин С. Ф., см. Бакуева Л. Г. 11/12, 1868  
 Мусихин С. Ф., Немов С. А., Прошин В. И., Семин И. Е., Шамшур Д. В., Березина А. В., Имамкулиев С. Д. Электрофизические свойства пленок  $(Sn_{0.8}Ge_{0.2})_{1-x}In_xTe$ , полученные методом лазерного напыления. 3, 513  
 Мухаммадиев О., см. Парицкий Л. Г. 11/12, 2011  
 Мыкенькая Г. С., см. Гуцев Г. Л. Бистабильные комплексы дефектов с углеродной компонентой в кремнии. 1, 67  
 Мыкенькая Г. С., см. Гуцев Г. Л. Реакции разрушения комплексов дефектов с образованием А-центров в кремнии. 3, 391  
 Назаров Н. см. Беркелиев А. 10, 1624  
 Назаров Н. см. Евстропов В. В. 4, 668  
 Назаров Н. см. Евстропов В. В. 8, 1319  
 Назаров Н. см. Жияев Ю. В. 10, 1611  
 Неверов В. Н., см. Арапов Ю. Г. 7, 1165  
 Неймаш В. Б., Помозов Ю. В., Шаховцов В. И., Кабалдин А. Н., Цмоць В. М. О влиянии нейтронного облучения на генерацию термодонов и преципитацию кислорода в кремнии при 650 °С. 10, 1651  
 Немов С. А., см. Гаврикова Т. А. 2, 200  
 Немов С. А., см. Житинская М. К. 10, 1724  
 Немов С. А., см. Мусихин С. Ф. 3, 513  
 Немов С. А., Равич Ю. И., Березин А. В., Гасумянц В. Э., Житинская М. К., Прошин В. И. Явление переноса в  $Pb_{0.78}Sn_{0.22}Te$  с большим содержанием примеси In. 2, 299  
 Немцов Г. З., см. Игнатьев А. С. 5, 755  
 Немчук Н. И., см. Дидейкин А. Т. 2, 362  
 Несвижский А. И., см. Кавокин А. В. 6, 977  
 Нетяга В. В., Григорчак И. И., Ковалюк З. Д. Некоторые физические свойства  $GaSe(MeNO_2)$  (Me—Na, K) и биинтерсталлов на их основе. 7, 1220  
 Нефедов А. А., см. Галкин И. М. 2, 239  
 Никитин В. А. см. Миляев В. А. 1, 99  
 Никитин М. С., см. Лашкарев Г. В. 8, 1381  
 Никитина А. Г., Зуев В. В. Особенности температурной зависимости концентрации свободных носителей в полупроводнике, содержащих бистабильную U—примесь. 7, 1211  
 Никишин С. А., см. Андреев В. М. 1, 141  
 Николаев М. В., см. Гусятников В. Н. 1, 182  
 Нинидзе Г. К., см. Добровольский В. Н. 6, 944  
 Нифтиев Н. Н., Рустамов А. Г., Тагиев О. Б. Электрические свойства слоистых монокристаллов  $MnGaInS_4$ . 3, 386  
 Новак В. И., см. Савицкий В. Г. 1, 95  
 Новиков А. Б., см. Абрамов А. П. 7, 1175  
 Новиков Б. В., см. Абрамов А. П. 7, 1175  
 Новиков С. В., см. Аверин С. В. 11/12, 1811  
 Новиков С. В., см. Бер Б. Я. 9, 1480  
 Новиков С. В., см. Быстров С. Д. 4, 645  
 Новиков С. В., см. Ле Туан. 6, 1007  
 Нойманн Х., см. Сырбу Н. Н. 1, 41  
 Нуркузиев Г., см. Азимов С. А. 7, 1073  
 Оганесян Г. А., см. Андреев В. А. 4, 567  
 Оганесян Г. А., см. Емцев В. В. 9, 1545  
 Оганесян Г. А., см. Емцев В. В. 9, 1549  
 Оганесян Г. А., см. Емцев В. В. 11/12, 2024  
 Оджаев В. Б., см. Аль-Баккур Ф. 5, 829

- Оксмендлер Б. Л., см. Юнусов М. С. 7, 1130
- Оксман М. М., см. Муминов Р. А. 2, 250
- Омельяновская Н. М., Краснобаев Л. Я., Федоров В. В. Влияние постимплантационного отжига на электрофизические свойства слоев кремния, имплантированного фтором. 4, 554
- Онопко Д. Е., Рыскин А. Р. Использование кластерного приближения для исследования легированного кристалла кремния. 8, 1361
- Орбух В. И., см. Лебедева Н. Н. 7, 1134
- Орлов Л. К., см. Арапов Ю. Г. 7, 1165
- Орлов Л. К., см. Кузнецов О. А. 10, 1591
- Ормонт Н. Н., см. Звягин И. П. 10, 1707
- Освальд И., см. Бреслер М. С. 4, 615
- Осинский В. И., см. Бойко С. И. 5, 815
- Осипов Е. Б., см. Костин И. В. 10, 1743
- Осипова Н. А., см. Костин И. В. 10, 1743
- Осташко Н. И., см. Жалко-Титаренко И. В. 10, 1698
- Остроумова Е. В., см. Берман Л. С. 6, 917
- Официрова Н. В., см. Сафаралиев Г. К. 3, 402
- Павлов В. Г., см. Владимирова Е. В. 8, 1400
- Павлова М. Л., см. Берман Л. С. 11/12, 1795
- Памяти Дмитрия Николаевича Намследова. 11/12, 1761
- Памяти Соломона Мееровича Рывкина. 11/12, 1871
- Памяти Юрия Васильевича Шмарцева. 3, 366
- Панаев И. А., см. Студеникин С. А. 5, 744
- Панграц И., см. Бреслер М. С. 4, 615
- Панов В. И., см. Антоненко В. И. 2, 221
- Пантелеев В. Н., см. Иванов П. А. 7, 1146
- Панчеха А. П., см. Басс Ф. Г. 10, 1747
- Паранчич С. Ю., см. Гавалешко Н. Н. 3, 459
- Парицкий Л. Г., Хайдаров З. Особенности контакта полупроводник—газовый разряд при малых межэлектродных расстояниях. 11/12, 2019
- Парицкий Л. Г., Хайдаров З., Мухаммадиев О., Дадабаев О. Исследование пространственной стабилизации тока в системе полупроводник—газовый разряд. 11/12, 2011
- Патракеев С. П., см. Кучинский П. В. 8, 1354
- Пахомов А. А., Яссиевич И. Н. Влияние границы раздела на захват и эмиссию носителей глубокими центрами. 3, 482
- Пашук Е. Г., см. Сафаралиев Г. К. 3, 402
- Пейкришвили М. Д., см. Адамашвили Г. Т. 5, 832
- Пенин Н. А., см. Асланов Г. А. 2, 277
- Пенцов А. В., см. Слободчиков С. В. 7, 1213
- Перепелкин А. Д., см. Яфясов А. М. 5, 762
- Перова И. А., см. Архипов В. И. 4, 682
- Першеев С. К., см. Куликов Г. С. 8, 1389
- Першеев С. К., см. Куликов Г. С. 8, 1392
- Петров А. Г., Шик А. Я. Межуровневые оптические переходы в квантовых ямах. 6, 1047
- Петров А. И., см. Горбылев В. А. 9, 1453
- Петров В. В., см. Аль-Баккур Ф. 5, 829
- Петрунин А. П., см. Кучинский П. В. 8, 1354
- Петрусенко В. Н., см. Добровольский В. Н. 6, 944
- Петухов В. Ю., см. Ибрагимова М. И. 4, 560
- Пильдон В. И., см. Глазов В. М. 10, 1605
- Пирогов В. И., см. Ионовенко А. Н. 6, 951
- Пихтин А. Н., Тодоров М. Т. Фотоотражение арсенида галлия. 7, 1139
- Плоог К., см. Мирлин Д. Н. 6, 990
- Плоппа Н. Г., см. Калинушкин В. П. 3, 538
- Плюхин А. В. Дисперсионный перенос в неупорядоченных органических полупроводниках. 4, 688
- Погадаев В. Г., см. Журавлев К. С. 9, 1473
- Подчищаева О. В., см. Галина Т. М. 8, 1379
- Пожела К., см. Пожела Ю. 3, 497
- Пожела Ю., Пожела К. Взаимодействие дрейфующих электронов с оптическими фононами. 3, 497
- Покатилов Е. П., см. Берил С. И. 1, 12
- Полетаев Н. К., см. Акимов А. В. 2, 310
- Полупанова А. Ф., см. Галиев В. И. 7, 1202
- Полянская Т. А., см. Быстров С. Д. 4, 645
- Помозов Ю. В., см. Неймаш В. Б. 10, 1651
- Попов А. А., см. Богословская А. Б. 9, 1574
- Попов А. И., см. Данченко А. А. 8, 1233
- Портной М. Е. Деполяризация фотолуминесценции при испускании оптических фононов горячими электронами в квантовых ямах. 3, 523
- Посвянский Д. В., см. Игнатъев А. С. 5, 775
- Потапов А. И., см. Брудный В. Н. 2, 260
- Потапов В. Т., см. Аверин С. В. 11/12, 1811
- Поцяск М., см. Валь А. 4, 622
- Прокопьев Е. П. Аннигиляция позитронов на примесях с глубокими уровнями в полупроводниках. 9, 1569
- Прокофьев В. К., см. Казакевич Л. А. 3, 535
- Просолович В. С., см. Аль-Баккур Ф. 5, 829
- Прохоров Е. Ф., см. Горев Н. Б. 6, 996
- Прохорович А. В., см. Винник Е. В. 4, 610
- Прохорович А. В., см. Винник Е. В. 5, 841
- Прохорович А. В., см. Винник Е. В. 6, 1030
- Прохорович А. В., см. Глинчук К. Д. 8, 1395
- Прошин В. И., см. Мусихин С. Ф. 3, 513
- Прошин В. И., см. Немов С. А. 2, 299
- Прошина О. В., см. Ипатова И. П. 11/12, 1873
- Пуртов Ю. Н., см. Краснов А. Н. 3, 511
- Пфайффер Л., см. Ашкинадзе Б. М. 11/12, 1953
- Пырля М. Н., см. Кульбачинский В. А. 4, 677
- Рабизо О. В., см. Бакуева Л. Г. 11/12, 1866
- Равич Ю. И., см. Житинская М. К. 10, 1724
- Равич Ю. И., см. Немов С. А. 2, 299
- Раренко А. И., см. Грицук Б. Н. 9, 1541
- Раренко А. И., Сирота А. В., Халамейда Д. Д. Инверсия линии циклотронного резонанса.

- нанса дырок в CdSb, наблюдаемого по изменению статической проводимости. 5, 851
- Растегаев В. П., см. Аннкин М. М. 1, 102
- Расулов Р. Я., Ганиев У. У., Сидикова Х. А. Теория фотогальванических эффектов в кристаллах со сложной зонной структурой при двухфотонном поглощении света. 4, 635
- Расулов Р. Я., Сидикова Х., Ганиев У. Теория фотогальванических эффектов в  $n$ -GaP. 3, 374
- Ребане Ю. Т., Шретер Ю. Г. Новые типы солнечных элементов на основе структур с переменной шириной запрещенной зоны. 11/12, 1925
- Ревин Д. Г., см. Алешкин В. Я. 7, 1190
- Регель А. Р., см. Глазов В. М. 7, 1080
- Резников Б. И., Царенков Г. В. Инверсия электрического поля у освещаемого анода МПМ диода. 8, 1262
- Ременюк А. Д., см. Берман Л. С. 11/12, 1795
- Ременюк А. Д., см. Лебедев А. А. 11/12, 1846
- Ремесник В. Г., см. Двуреченский А. В. 1, 168
- Решина И. И., Гук Е. Г. Комбинационное рассеяние и люминесценция пористого кремния. 5, 728
- Решиков М. А., см. Гуткин А. А. 9, 1516
- Решиков М. А., см. Гуткин А. А. 9, 1526
- Риеде В., см. Сырбу Н. Н. 1, 41
- Ризаханов М. А., Хамидов М. М. Фотоэлектрически активные и неактивные медленные центры прилипания электронов в кристаллах ZnSe. 5, 721
- Римшанс Я. С., см. Абашкина С. А. 6, 966
- Рогучий И. С., см. Жалко-Титаренко И. В. 10, 1698
- Рожко И. А., см. Бойко С. И. 5, 815
- Рожков В. А., Шалимова М. Б. Электрическое переклечение проводимости с памятью в кремниевых МДП структурах с диэлектриком из фторида эрбия. 3, 438
- Розенфельд Ю. Б., см. Васильев А. В. 8, 1305
- Рознован Ю. В. см. Смирнов Д. В. 10, 1631
- Ройзин Я. О., см. Вовк О. В. 8, 1349
- Романов Ю. А., см. Алешкин В. Я. 2, 329
- Романов Ю. А., см. Алешкин В. Я. 6, 931
- Романовский А. Преимущества режима переменного тока, наведенного электронным лучем, для определения параметров полупроводника. 3, 369
- Роткин В. В., см. Козырев С. В. 9, 1409
- Рошупкин А. М., см. Антипов С. А. 6, 937
- Рубец В. П., см. Беляев А. П. 3, 527
- Рубцова Р. А., см. Арапов Ю. Г. 7, 1165
- Рувимов С. С., см. Андреев В. М. 1, 141
- Рудь В. Ю., см. Беркелиев А. 10, 1624
- Рудь В. Ю., см. Беркелиев А. 10, 1624
- Рудь В. Ю., см. Жилиев Ю. В. 10, 1611
- Рудь В. Ю., см. Кесаманлы Ф. П. 11/12, 1761
- Рудь В. Ю., см. Киндяк В. В. 7, 1154
- Рудь В. Ю., см. Конников С. Г. 5, 757
- Рудь В. Ю., см. Константинова Н. Н. 5, 835
- Рудь В. Ю., см. Лебедев А. А. 11/12, 1846
- Рудь В. Ю., см. Магомедов М. А. 2, 245
- Руленко М. П., см. Дашевский З. М. 4, 662
- Румянцев В. Д., см. Андреев В. М. 1, 156
- Рустамов А. Г., см. Нифтиев Н. Н. 3, 386
- Рывкин Б. С., см. Бугусов Д. М. 2, 214
- Рыданов А. Ю., см. Вейс А. Н. 4, 701
- Рыжиков В. Д., см. Ембергенев Б. 8, 1240
- Рыльков В. В., см. Ждан А. Г. 5, 845
- Рыскин А. И., см. Васильев А. В. 8, 1305
- Рыскин А. И., Лангер Ежи М. Релаксация решетчи при фотоионизации глубоких примесей различной природы. 8, 1369
- Рыскин А. И., см. Оношко Д. Е. 8, 1361
- Рязанцев И. А., см. Двуреченский А. В. 1, 168
- Рябова Л. И., см. Акимов Б. А. 2, 351
- Сабирзянова Л. Д., см. Кулеев И. Г. 3, 519
- Сабликов В. А., см. Миргородский В. И. 1, 81
- Савельев И. Г., см. Бер Б. Я. 9, 1480
- Савельев И. Г., см. Быстров С. Д. 4, 645
- Савельев И. Г., см. Ле Туан. 6, 1007
- Савицкий В. Г., Соколовский Б. С., Новак В. И. Антистоксовское преобразование излучения варизонными полупроводниками при магнитоцентрационном эффекте. 1, 95
- Савицкий В. Г., см. Яфясов А. М. 5, 762
- Савкина Н. С., см. Аннкин М. М. 1, 102
- Савченко А. П., см. Болгов С. С. 1, 171
- Садофьев Ю. Г., см. Семенова Г. Н. 1, 162
- Садыков С. А., см. Сафаралиев Г. К. 3, 402
- Сазонов А. Ю., см. Будагян Б. Г. 8, 1365
- Саидов А. С., Лейдерман А. Ю., Сапаев Б., Каражанов С. Ж. Электрофизические свойства твердых растворов  $Si_{1-x}Ge_x$ , полученных методом жидкофазной эпитаксии. 2, 256
- Саинов Н. А., см. Ибрагимова М. И. 8, 1276
- Салихов Х. М., см. Слободчиков С. В. 7, 1213
- Салман Далла, см. Герчиков Л. Г. 1, 60
- Салманов А. Р., см. Казакевич Л. А. 3, 478
- Салманов А. Р., см. Казакевич Л. А. 3, 535
- Салманов А. Р., см. Казакевич Л. А. 10, 1680
- Самарин С. Н., см. Артамонов О. М. 10, 1730
- Самсонова Т. П., см. Иванов П. А. 7, 1146
- Санин А. Л. Влияние случайно распределенных доноров на динамику баллистических электронов. 5, 895
- Сапаев Б., см. Саидов А. С. 2, 256
- Сапега В. Ф., см. Мирлин Д. Н. 6, 990
- Сапелкин С. В., см. Мальшев В. А. 1, 179
- Сафаралиев Г. К., Таиров Ю. М., Цветков В. Ф., Шабанов Ш. Ш., Пашук Е. Г., Официрова Н. В., Авров Д. Д., Садыков С. А. Получение и свойства поликристаллических твердых растворов SiC—AlN. 3, 402
- Сафончик М. О., см. Смирнов Д. В. 10, 1631
- Сафронов Л. Н. Диффузия компонентов и примесей в кластеризующихся твердых растворах. 8, 1286
- Свердлова А. М., см. Кабанов В. Ф. 8, 1340

- Свительский А. В., см. Семенова Г. Н. 1, 162
- Сейсян Р. П., см. Ильинская Н. Д. 1, 108
- Сейсян Р. П., см. Кавокин А. В. 6, 977
- Селезнев В. Н., см. Терехов В. А. 9, 1577
- Семенова Г. Н., Кладько В. П., Крыштаб Т. Г., Садофьев Ю. Г., Свительский А. В., Корытцев С. В. Структурные дефекты и фотолюминесценция эпитаксиальных слоев  $\text{In}_x\text{Ga}_{1-x}\text{As}$ . 1, 162
- Семин И. Е., см. Мусихин С. Ф. 3, 513
- Сергеев Д. В., см. Евстропов В. В. 4, 668
- Сергеев Д. В., см. Евстропов В. В. 8, 1319
- Сидикова Х. А., см. Расулов Р. Я. 3, 374
- Сидикова Х. А., см. Расулов Р. Я. 4, 635
- Сизов Ф. Ф., см. Гавалешко Н. Н. 3, 459
- Силин А. П., см. Андришин Е. А. 8, 1256
- Сиповская М. А., см. Баранов А. Н. 3, 421
- Сиповская М. А., см. Воронина Т. И. 11/12, 1777
- Сиренко А. А., см. Мирлин Д. Н. 6, 990
- Сирота А. В., см. Грицко Б. Н. 9, 1541
- Сирота А. В., см. Раренко А. И. 5, 851
- Сиротюк С. В., см. Глазов В. М. 7, 1080
- Сиябеков Х. Б., см. Туланов В. Т. 10, 1751
- Скорятина Е. А., см. Дидик В. А. 2, 265
- Скорятина Е. А., см. Дидик В. А. 2, 343
- Скрыль Ю. И., см. Абашкина С. А. 6, 966
- Скучене А., см. Ашмонта С. 2, 307
- Слободчиков С. В., Ковалевская Г. Г., Пенцова А. В., Салихов Х. М. Усиление фототока в диодных структурах  $\text{Pd}-\text{SiO}_2-n(p)-\text{Si}$ . 7, 1213
- Слынько В. В., см. Выграненко Ю. К. 8, 1387
- Слынько Е. И., см. Акимов Б. А. 2, 351
- Слынько Е. И., см. Выграненко Ю. К. 8, 1387
- Смекалин К. Е., см. Андреев В. М. 1, 156
- Смирнов Д. В., Машовец Д. В., Сафончик М. О., Рознован Ю. В., Леонтен Ж., Кнапп В. Магнитофонный резонанс и инфракрасное решеточное отражение в  $p\text{-ZnSb}$ . 10, 1631
- Соботта Х., см. Сырбу Н. Н. 1, 41
- Соколовский Б. С., см. Савицкий В. Г. 1, 95
- Солдатенко Ю. Н., см. Васько Ф. Т. 4, 695
- Солдатенко Ю. Н., см. Васько Ф. Т. 6, 1058
- Солющенко В. И., см. Вовк О. В. 8, 1349
- Сосновский В. Р., см. Гуткин А. А. 9, 1516
- Сосновский В. Р., см. Гуткин А. А. 9, 1526
- Сохацкий А. С., см. Аль-Баккур Ф. 5, 829
- Сочинский Н. В., см. Бабенцов В. Н. 10, 1599
- Спрингхольц Г., см. Трофимов В. Т. 7, 1158
- Сресели О. М., см. Беляков Л. В. 8, 1371
- Сресели О. М., см. Беляков Л. В. 11/12, 1963
- Сресели О. М., см. Беляков Л. В. 11/12, 1815
- Становов О. Н., см. Будаган Б. Г. 9, 1489
- Стафеев В. И. Рецензия на книгу Таубкина И. И., Залетаева Н. Б., Кочерова В. Ф. «Физические явления в монокристаллических примесных фоторезисторах». 10, 1752
- Стафеев В. И., см. Воробьев Л. Е. 1, 146
- Степанов М. В., см. Андреев В. М. 1, 141
- Степанова М. Н., см. Урманов Н. А. 9, 1495
- Степихова М. В., см. Карпович И. А. 10, 1736
- Стерлев А. Н., см. Ковтун Г. П. 6, 1025
- Строкан Н. Б., см. Берман Л. С. 11/12, 1795
- Строкан Н. В., см. Вербицкая Е. М. 2, 205
- Строкан Н. В., см. Вербицкая Е. М. 7, 1113
- Строкан Н. Б., см. Вербицкая Е. М. 11/12, 2055
- Строкан Н. Б., см. Вербицкая Е. М. 11/12, 2071
- Стругова Е. О., см. Андреев В. М. 1, 156
- Стрыгин В. Д., см. Сысоев Б. И. 1, 131
- Студеникин С. А., Панаев И. А., Костюченко В. Я., Горчинов Х.-М. 3. Фотомангнитный эффект и фотопроводимость тонких эпитаксиальных слоев  $\text{Cd}_x\text{Hg}_{1-x}\text{Te}/\text{CdTe}$ . 5, 744
- Стусь Н. М., см. Айралиев М. 1, 21
- Субашиев А. В., см. Герчиков Л. Г. 1, 60
- Субашиев А. В., см. Герчиков Л. Г. 3, 446
- Субашиев А. В., см. Карпов В. Г. 5, 884
- Суворов А. В., см. Иванов П. А. 7, 1146
- Суворова Н. А., см. Вейс А. Н. 4, 701
- Сукач Г. А. Влияние нейтронного облучения на перемещение границы  $p-n$ -перехода в светодиодах на основе  $\text{GaAsP}(\text{Zn})$ . 5, 838
- Сукач А. В., см. Богословская А. Б. 9, 1574
- Сукач А. В., см. Мозоль П. Е. 11/12, 1820
- Сулейманов Р. А., см. Алекперов О. Э. 7, 1180
- Сулеман Х., Лигачев В. А., Филиков В. А. Морфология, плотность состояний и поляризация в неоднородных слоях  $a\text{-Si}$ : Н. 2, 338
- Суриков И. Н., см. Кучинский П. В. 8, 1354
- Суханов В. Л., см. Вербицкая Е. М. 11/12, 2055
- Сучалкин С. Д., см. Васильев Ю. Б. 11/12, 1992
- Сучалкин С. Д., Васильев Ю. Б., Иванов Ю. Л. Влияние интерференции в подложке на форму линии циклотронного поглощения двумерного электронного газа (Методическая заметка). 11/12, 2078
- Сучалкин С. Д., см. Иванов Ю. Л. 11/12, 1997
- Сырбу Н. Н., Нойманн Х., Соботта Х., Риеде В. Давыдовские мультиплеты колебательных спектров и эффективные ионные заряды в кристаллах  $\text{TlInS}_2$ ,  $\text{TlGaSe}_2$ . 1, 41
- Сыркин А. Л., см. Аникин М. М. 1, 102
- Сысоев Б. И., Безрядин Н. Н., Котов Г. И., Стрыгин В. Д. Влияние обработки поверхности арсенида галлия в парах халькогенов на свойства барьеров Шоттки в структурах  $\text{Me}-\text{GaAs}$ . 1, 131
- Табаров Т. С., см. Абашкина С. А. 6, 966
- Тагиев О. Б., см. Нифтиев Н. Н. 3, 386
- Таиров Ю. М., см. Сафаралиев Г. К. 3, 402
- Талалакин Г. Н., см. Айдаралиев М. В. 2, 1
- Талипов Н. Х., см. Двуреченский А. В. 1, 168



- Ганклевская Е. М., см. Андреев В. М. 1, 141
- Гаран Ю. Н., см. Глазов В. М. 7, 1080
- Тарбаев Н. И., см. Бабенцов В. Н. 10, 1599
- Татаринцев А. В., см. Левин М. Н. 1, 3
- Герентьев А. И., см. Матвеев О. А. 11/12, 1894
- Терехов В. А., см. Голикова О. А. 9, 1468
- Терехов В. А., Селезнев В. Н., Домашевская Э. П. О влиянии электрического пучка на энергетическое распределение локализованных состояний в аморфном нитриде кремния. 9, 1577
- Терухов Е. И., см. Данишевский А. М. 6, 913
- Тетельбаум Д. И., Якунин Ю. И., Касаткин А. П., Мурель А. В. Моделирование профилей распределения концентрации носителей тока в LOW—HIGH-переходах с промежуточным слоем противоположного типа легирования. 10, 1657
- Тетеркин В. В., см. Гавалешко Н. Н. 3, 459
- Тиме Т. В., см. Калинушкин В. П. 3, 538
- Тимченко И. Н., см. Воронина Т. И. 11/12, 1777
- Титков А. Н., см. Болотов Л. Н. 8, 1375
- Титков А. Н., см. Бреслер М. С. 4, 615
- Титов О. Ю., см. Гуревич Ю. Г. 6, 1040
- Тодоров М. Т., см. Пыхтин А. Н. 7, 1139
- Тодуа П. А., см. Антоненко В. И. 2, 221
- Токарев В. П., см. Шаповалов В. П. 11/12, 1851
- Томасов А. А., см. Иваницкая О. И. 11/12, 1885
- Торчинов Х.-М. З., см. Студеникин С. А. 5, 744
- Тошходжаев Х. А., см. Беляев А. П. 3, 527
- Третьяков В. В., см. Бер Б. Я. 9, 1480
- Триберис Г. П. Детальное изучение проводимости на постоянном токе в разупорядоченных системах за счет прыжкового перемещения поляронов малого радиуса. 5, 862
- Тростянский С. Н., см. Голикова О. А. 9, 1468
- Трофимов В. Т., Аббасов Г. З., Спрингхольц Г., Бауэр Г., Засавицкий И. И. Энергетическая диаграмма гетероперехода  $Pb_{1-x}Mn_xTe/PbTe$ . 7, 1158
- Трухан В. М., см. Федотов В. Г. 4, 551
- Туланов В. Т., см. Горлин Г. Б. 11/12, 1963
- Туланов В. Т., Сиябеков Х. Б. Индуцированная примесная фотопроводимость в кремнии, легированном серой. 10, 1751
- Турсунов И. Г., см. Абдураимов А. 3, 516
- Тысченко И. Е., см. Кафонова И. В. 2, 234
- Тысченко И. Е., см. Качурин Г. А. 7, 1194
- Уколов А. Т., см. Горяев Н. Б. 6, 996
- Уласюк В. Н., см. Антоненко В. И. 2, 221
- Урманов Н. А., Гафурова М. В. Аномальные (с двумя максимумами) пики в спектрах токовой спектроскопии в  $p-n$ -структуре, связанные с одним типом глубоких состояний. 9, 1535
- Урманов Н. А., Степанова М. Н. Изотермическая и термостимулированная релаксация тока и емкости в слабо асимметричном  $p-n$ -переходе с неоднородным профилем легирования  $n$ - и  $p$ -областей. 9, 1572
- Урманов Н. А., Гафурова М. В. Влияние начального заполнения глубоких центров на положение пика термостимулированного тока в  $n^+ - p$ -переходе с произвольным отношением концентрации мелких и глубоких центров. 9, 1572
- Урманов Н. А., Степанова М. Н. Изотермическая и термостимулированная релаксация тока и емкости в слабо асимметричном  $p-n$ -переходе с неоднородным профилем легирования  $n$ - и  $p$ -областей. 9, 1572
- Усманов Ш., см. Аронов Д. А. 6, 1014
- Устинов В. М., см. Иванов Ю. Л. 11/12, 2080
- Утамурадова Ш. Б., см. Абдурахманов К. П. 7, 1222
- Фай Л. К., см. Берил С. И. 1, 12
- Файзрахманов И. А., см. Ибрагимова М. И. 8, 1276
- Фалькевич Э. С., см. Глазов В. М. 7, 1080
- Фарах М., см. Берил С. И. 1, 12
- Фарина И. А., см. Гнатенко Ю. П. 10, 1639
- Федорин В. А. Суперионные свойства полупроводника  $Cu_{2-x}Se$  как проявления экситонной фазы с переносом заряда. 3, 354
- Федоров Л. М., см. Беркелиев А. 10, 1624
- Федоров Л. М., см. Евстропов В. В. 4, 668
- Федоров Л. М., см. Евстропов В. В. 8, 1319
- Федоров Л. М., см. Жилев Ю. В. 10, 1611
- Федоров В. В., см. Омеляновская Н. М. 4, 554
- Федоров В. Г., Гатальский Г. В., Трухан В. М. Влияние радиационного облучения на люминесценцию кристаллов  $CdP_2$ . 4, 551
- Фетисов Н. В., см. Кудряшов Н. А. 2, 358
- Филатов А. Л., см. Миргородский В. И. 1, 81
- Филиков В. А., см. Сулеман Х. 2, 338
- Фирсов Д. А., см. Воробьев Л. Е. 1, 146
- Фистуль В. И. Перколяция тока в полимеро-полупроводниковой структуре. 11/12, 1788
- Фистуль В. И., см. Волков Д. А. 3, 431
- Фистуль В. И., Шмугуров А. В. Междоузельные состояния  $f$ -примесей в кремнии. 11/12, 1910
- Фишер Р., см. Кулибеков А. 7, 1229
- Fishman L. M. Scattering of Surface Acoustic Waves and Heat Transfer through the Nonuniform Interface. 11/12, 1918
- Хаарер Д., см. Кулибеков А. 7, 1229
- Хабибуллаев П. К., см. Закиров А. С. 9, 1556
- Хайбуллин И. Б., см. Ибрагимова М. И. 4, 560
- Хайбуллин И. Б., см. Ибрагимова М. И. 8, 1276
- Хайдаров З., см. Парицкий Л. Г. 11/12, 2011
- Хайдаров З., см. Парицкий Л. Г. 11/12, 2019
- Хакимов М., см. Юнусов М. С. 7, 1130
- Халамейда Д. Д., см. Грицюк Б. Н. 9, 1541
- Халамейда Д. Д., см. Раренко А. И. 5, 851
- Халфин В. Б., см. Гарбузов Д. 3. 10, 1713

- Хамидов М. М., см. Ризаханов М. А. 5, 721  
Ханин Ю. Н., см. Ларкин И. А. 11/12, 1800  
Харус Г. И., см. Арапов Ю. Г. 7, 1165  
Хвостиков В. П., см. Андреев В. М. 1, 141  
Хейме К., см. Аверин С. В. 11/12, 1811  
Химматкулов О., см. Абдураимов А. 3, 516  
Химматкулов О., см. Абдураимов А. 7, 1216  
Хорев С. А., см. Астров Ю. А. 11/12, 2027  
Хохлов Д. Р., см. Акимов Б. А. 2, 351
- Царев А. Н., см. Аверин С. В. 11/12, 1811  
Царенков Г. В., см. Резников Б. И. 8, 1262  
Цветков В. Ф., см. Сафаралиев Г. К. 3, 402  
Цидильковский Э. И., см. Андрухив А. М. 2, 348  
Цидильковский И. М., см. Кулеев И. Г. 3, 519  
Цмоць В. М., см. Неймаш В. Б. 10, 1651  
Цыпишка Д. И., Иванов-Омский В. И., Георгиц Е. И., Гуцуляк Л. М., Миранов К. Е. Фотовозбуждение мелких акцепторов в  $Cd_xHg_{1-x}Te$ . 4, 714  
Цюцюра Д. И., Шкумбатюк П. С. Получение  $p-n$ -переходов на  $CdTe(In)$  лазерным отжигом. 6, 1064
- Чалдышев В. В., см. Бер Б. Я. 9, 1480  
Чапланов В. А., см. Галкин И. М. 2, 239  
Чебан В. Н., см. Бреслер М. С. 4, 615  
Чеботарев А. П., см. Воронова И. Д. 5, 827  
Челноков В. Е., см. Аникин М. М. 1, 102  
Челноков В. Е., см. Иванов П. А. 7, 1146  
Чельный А. А., см. Горбылев В. А. 9, 1453  
Червяков Г. Г., см. Малышев В. А. 1, 179  
Черненко И. М., см. Мекекечко А. Ю. 6, 1060  
Чернов А. Л., см. Арапов Ю. Г. 7, 1165  
Чернышев В. Е., см. Левин М. Н. 1, 3  
Чеснис А. А. О механизме возникновения отрицательного дифференциального сопротивления в тонких пленках аморфного селена. 5, 848  
Чкунина В. Н., см. Вовк О. В. 8, 1349  
Чукина В. М., см. Горбылев В. А. 9, 1453  
Чуприков Н. Л. Временные характеристики одночастичного рассеяния в одномерных системах. 5, 799  
Чураков Г. В., см. Иванов Ю. Л. 11/12, 2080  
Чусовитин М. С., см. Данишевский А. М. 6, 913
- Шабанов Ш. Ш., см. Сафаралиев Г. К. 3, 402  
Шаймеев С. С., см. Антонова И. В. 2, 234  
Шалимова М. Б., см. Рожков В. А. 3, 438  
Шамирзаев Т. С., см. Журавлев К. С. 9, 1473  
Шамонина Е. А., см. Казанский А. Г. 10, 1688  
Шамшур Д. В., см. Мусихин С. Ф. 3, 513  
Шангина Е. Л., см. Кадушкин В. И. 8, 1311  
Шапиро Б. Орбитальный магнитный отклик в мезоскопических проводниках. 5, 854  
Шаповалов В. П., Грядун В. И., Токарев В. П. Кинетика образования структурных дефектов на поверхности пленки кремния при термическом окислении. 11/12, 1851
- Шаронова Л. В., см. Бакуева Л. Г. 11/12, 1866  
Шаронова Л. В., см. Бакуева Л. Г. 11/12, 1868  
Шаронова Л. В., см. Макарова Т. Л. 11/12, 1830  
Шафран А. Г., см. Ждан А. Г. 5, 845  
Шахлевич Л. Н., см. Кучинский П. В. 8, 1354  
Шаховцов В. И., см. Неймаш В. Б. 10, 1651  
Шаховцов К. В., см. Шаховцова С. И. 6, 1035  
Шаховцова С. И., Шаховцов К. В., Шпинар Л. И., Ясковец И. И. Масштаб флуктуации состава в сплавах  $Ge_{1-x}Si_x$ . 6, 1035  
Шегай О. А., см. Журавлев К. С. 9, 1473  
Шелюшников Д. Н., см. Ле Туан. 6, 1007  
Шелушинина Н. Г., см. Арапов Ю. Г. 7, 1165  
Шепельский Г. А., см. Гасан-заде С. Г. 8, 1326  
Шепельский Г. А., см. Гасан-заде. 9, 1508  
Шерегий Е. М., см. Валь А. 4, 622  
Шерняков Ю. М., см. Гарбузов Д. З. 10, 1713  
Шерняков Ю. М., см. Евстропов В. В. 8, 1319  
Шерстнев В. В., см. Баранов А. Н. 3, 421  
Шеховцов Н. А. Поглощение электромагнитного излучения 54—78 ГГц слабо легированным р-германием. 10, 1720  
Шик А. Я., см. Петров А. Г. 6, 1047  
Шилейка А., см. Кавалаяускас Ю. 7, 1086  
Шимечек Т., см. Бреслер М. С. 4, 615  
Шипов И. А., см. Галкин И. М. 2, 239  
Ширков А. В., см. Миляев В. А. 1, 99  
Ширмулис Э., см. Ашмонтас С. 7, 1185  
Ширяев С. В., см. Дутов А. Г. 6, 1001  
Шкумбатюк П. С., см. Цюцюра Д. И. 6, 1064
- Шлимак И. С. Явление перехода от закона Эфроса—Шкловского к закону Мотта в прыжковой проводимости с переменной длиной прыжка. 11/12, 1845
- Шмальц К., см. Андреев Б. А. 4, 567  
Шмальц К., см. Емцев В. В. 9, 1545  
Шмальц К., см. Емцев В. В. 9, 1549  
Шмальц К., см. Емцев В. В. 11/12, 2024
- Шмарцев Ю. В., см. Аверин С. В. 11/12, 1811  
Шмарцев Ю. В., см. Бер Б. Я. 9, 1480  
Шмарцев Ю. В., см. Макарова Т. Л. 11/12, 1830  
Шмарцев Ю. В., см. Ле Туан. 6, 1007
- Шматов А. А. Обработка спектров релаксационной спектроскопии глубоких уровней методом математического моделирования. 8, 1282  
Шмелев Г. М., Железняк А. Т. Фотостимулированные осцилляции экранированного вырожденным электронным газом кулоновского поля. 7, 1224  
Шмидт Б., см. Вербицкая Е. М. 11/12, 2055  
Шмидт Б., см. Вербицкая Е. М. 11/12, 2071  
Шмугуров А. В., см. Фистуль В. И. 11/12, 1910

- Шнайдер И. П., см. Викулина К. И. 4, 712  
 Шофман В. Г., см. Акимов А. В. 2, 310  
 Шпатаковская Г. В., см. Гергель В. А. 6, 923  
 Шпинар Л. И., см. Шаховцова С. И. 6, 1035  
 Шретер Ю. Г., см. Ребане Ю. Т. 11/12, 1925  
 Штрапенин Г. Л., см. Арапов Ю. Г. 7, 1165  
 Шулекин А. Ф., см. Грехов И. В. 1, 88  
 Шуман В. Б., см. Андрианов А. В. 1, 136
- Шербань А. П., см. Ковтун Г. П. 6, 1025  
 Шукин В. А., см. Ипатова И. П. 2, 285  
 Шукин В. А., см. Ипатова И. П. 11/12, 1873  
 Шукин В. А., см. Малышкин В. Г. 11/12, 1932
- Экке В., см. Лебедев А. А. 1, 76  
 Ора Энтин-Вольман, см. Ювал Гефен. 5, 859  
 Эппель В. И., см. Горев Н. Б. 6, 996
- Юбов Ю. М., см. Аронов Д. А. 6, 1014  
 Ювал Гефен, Ора Энтин-Вольман. Анионы в ограниченной одномерной геометрии. 5, 859  
 Юнович А. Э., см. Горбылев В. А. 9, 1453  
 Юнусов М. С., см. Азимов С. А. 7, 1073  
 Юнусов М. С., Каримов М., Оксенгендлер Б. Л., Хакимов М. К вопросу о радиационном дефектообразовании в нейтронно-легированном кремнии. 7, 1130  
 Юнусова Х., см. Муминов Р. А. 2, 250  
 Юрьев В. А., см. Калинушкин В. П. 1, 188  
 Юрьев В. А., см. Калинушкин В. П. 3, 538
- Юсупов Р. Г., см. Антоненко В. И. 2, 221  
 Юсупова Ш. А., см. Абдурахманов К. П. 7, 1222  
 Юхимец Е. А., см. Малышев В. А. 1, 179
- Явич Б. С., см. Гарбузов Д. З. 10, 1713  
 Якимов С. С., см. Галкин И. М. 2, 239  
 Яковлев И. И., см. Артамонов О. М. 10, 1730  
 Яковлев Н. В., см. Иваницкая О. И. 11/12, 1885  
 Яковлев Ю. П., см. Баранов А. Н. 3, 421  
 Яковлев Ю. П., см. Бреслер М. С. 4, 615  
 Яковлев Ю. П., см. Воронина Т. И. 11/12, 1777  
 Якушин Ю. И., см. Тетельбаум Д. И. 10, 1657  
 Якушева Н. А., см. Журавлев К. С. 9, 1473  
 Янковский О. Н., см. Аль-Баккур Ф. 5, 829  
 Яркин Д. Г., см. Казанский А. Г. 10, 1693  
 Ярошецкий И. Д., см. Андрианов А. В. 1, 136  
 Ярошецкий И. Д., см. Беляков Л. В. 8, 1371  
 Ярошецкий И. Д., см. Беляков Л. В. 11/12, 1963  
 Ярошецкий И. Д., см. Беляков Л. В. 11/12, 1815  
 Яссиевич И. Н., см. Бреслер М. С. 5, 871  
 Яссиевич И. Н., см. Пахомов А. А. 3, 482  
 Ясковец И. И., см. Шаховцова С. И. 6, 1035  
 Яськов Д. А., см. Андреева Е. В. 7, 1095  
 Ятлинко И. И., см. Казакова Л. П. 6, 959  
 Яфясов А. М., Савицкий В. Г., Ковтун Р. Н., Перепелкин А. Д., Божевольнов В. Б. Исследование параметров зонной структуры в приповерхностных слоях эпитаксиальных пленок узкощелевых твердых растворов  $Zn_xHg_{1-x}Te$ . 5, 762